

Предметный указатель

Содержание

1. Персоналии	1513	5.6.2. Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)	1529
2. Обзоры	1513	5.6.3. Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)	1529
3. Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)	1513	5.6.4. Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т.п.) (PACS 78.66)	1531
3.1. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)	1514	5.7. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)	1531
4. Структура, механические и термические свойства (PACS 60)	1514	6. Физика полупроводниковых приборов (PACS 84; 85)	1532
4.1. Структура, кристаллография (PACS 61)	1514	7. Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур (PACS 81; 85)	1533
4.1.1. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)	1515		
4.1.2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)	1515		
4.1.3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)	1515		
4.1.4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)	1516		
4.1.5. Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)	1516		
4.2. Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)	1517		
4.3. Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)	1517		
4.4. Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)	1517		
4.5. Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)	1518		
5. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)	1519		
5.1. Электронные состояния (PACS 71)	1519		
5.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)	1519		
5.2. Транспортные явления (PACS 72)	1520		
5.2.1. Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)	1521		
5.2.2. Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)	1521		
5.2.3. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)	1521		
5.3. Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)	1522		
5.3.1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)	1523		
5.3.2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30)	1524		
5.3.3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)	1524		
5.3.4. Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)	1526		
5.4. Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)	1526		
5.5. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)	1527		
5.6. Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)	1527		
5.6.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)	1528		

1. Персоналии

Захарий Фишелевич Красильник (к 60-летию со дня рождения)	4	503
Владимир Иванович Иванов-Омский (к 75-летию со дня рождения)	4	505
Владимир Иделевич Перель (К 80-летию со дня рождения).	8	897
О Владимире Иделевиче Переле. Ю.Н. Демков	8	898
Памяти Людмилы Германовны Лаврентьевой.	9	1150

2. Обзоры

Возможности и основные принципы управления пластической релаксацией пленок GeSi/Si и Ge/Si ступенчато изменяемого состава. Ю.Б. Болховитянов, А.К. Гутаковский, А.С. Дерябин, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов	1	3
Примесные резонансные состояния в полупроводниках. В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко, М.А. Одноблудов, И.Н. Ясиевич	8	899

3. Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)

Влияние процесса плавления на акустический отклик соединений CdTe и GaAs при импульсном лазерном облучении. А. Байдуллаева, В.П. Велещук, А.И. Власенко, Б.К. Даулетмуратов, О.В. Ляшенко, П.Е. Мозоль	3	286
Эффективная генерация первой волноводной моды в гетеролазере InGaAs/GaAs/InGaP. А.А. Бирюков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, В.Я. Алёшкин, А.А. Дубинов, В.В. Кочаровский, Вл.В. Кочаровский	3	361
Динамика формирования фотоответа в детекторной структуре из арсенида галлия. Г.И. Айзенштат, М.А. Лелеков, О.П. Толбанов	4	451
Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. I. Теория, оптические свойства материалов. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов	7	864

- Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. II. Анализ гетероструктур на различных подложках. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов 7 871
- Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 835 нм на основе различных типов лазерных гетероструктур. А.В. Мурашова, Д.А. Винокуров, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, В.В. Шамахов, В.В. Васильева, В.А. Капитонов, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, Т.А. Налет, Д.Н. Николаев, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, И.С. Тарасов, Y.S. Kim, D.H. Kang, C.Y. Lee 7 882
- Residual resistance and Joule heat generation in bulk samples and nanostructures. V. L. Gurevich 8 931
- Edge effects in propagation of terahertz radiation in subwavelength periodic structures. B. Gelmont, R. Parthasarathy, T. Globus 8 940
- Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневой, А.Н. Кривоносов, Т.А. Налет 9 1053
- Влияние уровня возбуждения на оптические свойства микродиска GaAs—AlGaO с активной областью на основе квантовых точек InAs. А.М. Надточий, С.А. Блохин, А.В. Сахаров, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, Е. Шток, Т. Варминг, Д. Бимберг 10 1247
- Свойства волноводных мод в фотонном кристалле на основе щелевого кремния с дефектом. А.С. Спицын, Г.Ф. Глинский 10 1256
- Структурные и энергетические характеристики собственных дефектов вакансионного типа в двуоснонапряженной решетке GaN. Т.В. Безъязычная, В.М. Зеленковский, А.Л. Гурский, Г.И. Рябцев 11 1281
- Быстрые оптические регистрирующие среды на полупроводниковых наноструктурах для записи и обработки изображений. П.Г. Кашерининов, А.А. Томасов 11 1391
- Субтерагерцовые автоколебания в сверхбыстрой автомодуляции поглощения света в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневой, А.Н. Кривоносов 12 1426
- 3.1. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)**
- Вклад оже-рекомбинации в насыщение ватт-амперных характеристик мощных полупроводниковых лазеров ($\lambda = 1.0-1.9$ мкм). А.В. Лютецкий, К.С. Борщев, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов 1 106
- Оптические параметры диодных лазеров на основе InAsSb/InAsSbP-гетероструктуры. А.П. Астахова, Т.В. Безъязычная, Л.И. Буров, А.С. Горбачевич, А.Г. Рябцев, Г.И. Рябцев, М.А. Щемелев, Ю.П. Яковлев 2 228
- Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 808 нм на основе различных типов асимметричных гетероструктур со сверхшироким волноводом. В.В. Безотосный, В.В. Васильева, Д.А. Винокуров, В.А. Капитонов, О.Н. Крохин, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, А.В. Мурашова, Т.А. Налет, Д.Н. Николаев, Н.А. Пихтин, Ю.М. Попов, С.О. Слипченко, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, В.В. Шамахов, И.С. Тарасов 3 357
- Эффективная генерация первой волноводной моды в гетеролазере InGaAs/GaAs/InGaP. А.А. Бирюков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, В.Я. Алёшкин, А.А. Дубинов, В.В. Кочаровский, В.Л. Кочаровский 3 361
- Нелинейно-оптическое преобразование частоты в двухцветном лазере с вертикальным внешним резонатором. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, Т. Leinonen, М.Ю. Морозов 4 473
- Пороговые характеристики ИК-лазера на основе глубоких квантовых ям InAsSb/AlSb. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря 5 573
- Каскадный лазер на мелких донорах в δ -легированных сверхрешетках GaAs/AlGaAs. Н.А. Бекин, В.Н. Шастин 5 622
- Концентрация и температура носителей заряда в квантовых ямах лазерных гетероструктур в режимах спонтанного и стимулированного излучения. Л.Е. Воробьев, В.Л. Зерова, К.С. Борщев, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов, G. Belenky 6 753
- Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов 7 823
- Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. I. Теория, оптические свойства материалов. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов 7 864
- Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. II. Анализ гетероструктур на различных подложках. Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов 7 871
- Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 835 нм на основе различных типов лазерных гетероструктур. А.В. Мурашова, Д.А. Винокуров, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, В.В. Шамахов, В.В. Васильева, В.А. Капитонов, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, Т.А. Налет, Д.Н. Николаев, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, И.С. Тарасов, Y.S. Kim, D.H. Kang, C.Y. Lee 7 882
- Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электроннолучевой накачкой на основе многослойных наноструктур $A^{IV}B^{VI}$. М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, Д.В. Перегудов, В.Б. Студенов, И.В. Седова, С.В. Гронин, С.В. Сорокин, С.В. Иванов, П.С. Копьев 12 1472
- 4. Структура, механические и термические свойства (PACS 60)**
- 4.1. Структура, кристаллография (PACS 61)**
- Высокотемпературные матрицы детекторов ядерного излучения на основе $4H$ -SiC ионно-легированных p^+-n -переходов. Е.В. Калинина, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Ситникова, А.В. Садохин, А.Ю. Азаров, В.Г. Коссов, Р.Р. Яфаев 1 87
- Влияние электронного облучения на скорость удаления носителей в кремнии и карбиде кремния модификации $4H$. В.В. Козловский, В.В. Емцев, К.В. Емцев, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, В.Н. Ломасов, Г.А. Оганесян, А.А. Лебедев 2 243

Влияние облучения электронами и протонами на характеристики поверхностно-барьерных структур SiC-детекторов ядерных излучений. А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, В.В. Козловский, А.А. Лебедев	3	370
Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин	4	399
Исследование самоорганизации неупорядоченных материалов с применением теории информации. Т.Г. Авачева, Н.В. Бодягин, С.П. Вихров, С.М. Мурсалов	5	513
CdTe как пассивирующий слой в гетероструктуре CdTe/HgCdTe. И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф.Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов	7	788
Влияние кислорода на структуру и электронные свойства нанокластеров кремния Si _n (n = 5, 6, 10, 18). А.А. Гниденко, В.Г. Заводинский	7	817
Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности n-6H-SiC под воздействием сверхвысокочастотной обработки. Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин, О.Б. Охрименко, А.М. Светличный, В.В. Поляков	7	888
О пространственной симметрии возбужденных состояний в полупроводниках A ^{III} B ^V в Г-точке. В.Д. Дымников, О.В. Константинов	8	934
Особенности использования широкозонных полупроводящих материалов в задачах регистрации ядерного излучения. А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, А.А. Лебедев	9	1135
Особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая	10	1263
Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк	11	1321
Энергетический спектр носителей заряда в Ag ₂ Te. С.А. Алиев, З.Ф. Агаев, Р.И. Селим-заде	12	1415
К вопросу радиационной стойкости SiC при чередовании стадий облучения и отжига. А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, А.А. Лебедев	12	1466

4.1.1. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)

Исследование монокристаллов тройного соединения CuIn ₃ Se ₅ . И.В. Боднар	9	1046
Состав и параметры доменов, образующихся в результате спиноподального распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах GaInP/Ga _x In _{1-x} As _y P _{1-y} /GaInP/GaAs(001). Э.П. Домашевская, Н.Н. Гордиенко, Н.А. Румянцева, П.В. Середин, Б.Л. Агапов, Л.А. Битюцкая, И.Н. Арсентьев, Л.С. Вавилова, И.С. Тарасов	9	1086
Электрофизические и структурные свойства двусторонне δ-легированных PHEMT-гетероструктур на основе AlGaAs/InGaAs/AlGaAs. И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, В.Г. Мокеров, С.С. Широков, Р.М. Имамов, И.А. Субботин	9	1102

4.1.2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)

Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь	2	208
Нанокластеры платины, инкапсулированные в аморфный углерод. Т.К. Звонарева, А.А. Ситникова, Г.С. Фролова, В.И. Иванов-Омский	3	331
Влияние температуры и интенсивности освещения на образование метастабильных состояний в a-Si:Н. И.А. Курова, Н.Н. Ормонт	4	447
Исследование самоорганизации неупорядоченных материалов с применением теории информации. Т.Г. Авачева, Н.В. Бодягин, С.П. Вихров, С.М. Мурсалов	5	513
Исследование свойств поверхности арсенида галлия методом сканирующей атомно-силовой микроскопии. В.Г. Божков, Н.А. Торхов, И.В. Ивонин, В.А. Новиков	5	546
Электроннографическое исследование параметров ближнего порядка в аморфных пленках Yb _{1-x} Sm _x As ₂ S ₄ . Э.Ш. Гаджиев, А.И. Мададзаде	5	608
Термическая неустойчивость фуллеренов кремния, стабилизируемых водородом. Компьютерный эксперимент. А.Е. Галашев	5	611
Колебательная спектроскопия аморфного углерода, модифицированного Pt. В.И. Иванов-Омский, Т.К. Звонарева, Г.С. Фролова	9	1131
Свойства и структура стекол (As ₂ Se ₃) _{1-z} (SnSe) _{z-x} (Te ₂ Se) _x и (As ₂ Se ₃) _{1-z} (SnSe) _{z-x} (Te ₂ Se) _x . Г.А. Бордовский, А.В. Марченко, Е.И. Теруков, П.П. Серегин, Т.В. Лиходеева	11	1353
Особенности световых вольт-амперных характеристик p-i-n-структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса темного тока. А.А. Андреев	11	1363

4.1.3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)

Вариация края поглощения света в пленках SiN _x с кластерами кремния. М.Д. Ефремов, В.А. Володин, Д.В. Марин, С.А. Аржанникова, Г.Н. Камаев, С.А. Кочубей, А.А. Попов	2	202
Нанокластеры платины, инкапсулированные в аморфный углерод. Т.К. Звонарева, А.А. Ситникова, Г.С. Фролова, В.И. Иванов-Омский	3	331
Латеральное упорядочение нановискеров GaAs на поверхностях GaAs(111)В и GaAs(110) при молекулярно-пучковой эпитаксии. Г.Э. Цырлин, Н.В. Сибирев, С. Sartel, J.-C. Harmand	6	726
Формирование SiO _x -слоев при плазменном распылении Si- и SiO ₂ -мишеней. А.Н. Карпов, Д.В. Марин, В.А. Володин, J. Jedrzejewski, Г.А. Качурин, Е. Savir, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая, Y. Goldstein, I. Balberg	6	747
Влияние кислорода на структуру и электронные свойства нанокластеров кремния Si _n (n = 5, 6, 10, 18). А.А. Гниденко, В.Г. Заводинский	7	817

- Фотолюминесценция нанокластеров GeSi/Si, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа.** Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов 9 1116
- Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния.** Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, В.А. Володин 9 1145
- О зависимости высоты нитевидных нанокристаллов GaAs от скорости осаждения.** Н.В. Сибирёв, В.Г. Дубровский, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Ю.Б. Самсоненко, В.М. Устинов 11 1286
- 4.1.4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)**
- Возможности и основные принципы управления пластической релаксацией пленок GeSi/Si и Ge/Si ступенчато изменяемого состава.** Ю.Б. Болховитянов, А.К. Гутаковский, А.С. Дерябин, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов 1 3
- Зависимость изгиба зон на границе микроконтакта AgBr—AgI от формы и размера гетерогенной системы.** А.В. Ханефт, А.С. Поплавной, Б.А. Сечкарев, Л.В. Сотникова 1 40
- Бистабильные амфотерные центры в полупроводнике.** А.Г. Никитина, В.В. Зуев 2 141
- Ионизация в электрическом поле DX-центра, связанного с серой, в In_{1-x}Ga_xP.** Ю.К. Крутоголов 2 171
- Действие мощных нано- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры.** Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deuschmann 2 181
- Моделирование приповерхностной протонно-стимулированной диффузии бора в кремнии.** О.В. Александров, В.В. Козловский 3 262
- Определение энергии и концентрации амфотерных дефектов методом дифференциальной обработки температурной зависимости концентрации свободных носителей.** А.Г. Никитина, В.В. Зуев 4 389
- Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Си монокристаллов CdS.** Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин 4 399
- Исследование зависимости электрофизических параметров пленок Cd_xHg_{1-x}Te, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, от уровня легирования индием.** В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Д.Г. Икусов, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, Г.Ю. Сидоров, М.В. Якушев 6 664
- Исследование влияния температуры крекинга мышьяка на эффективность его встраивания в пленки CdHgTe в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии.** Г.Ю. Сидоров, Н.Н. Михайлов, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Ю.Г. Сидоров, С.А. Дворецкий 6 668
- Кинетика формирования различных типов водородсодержащих доноров в кремнии, имплантированном протонами.** Ю.М. Покотило, А.Н. Петух, О.А. Дзичковский 7 893
- Процессы возбуждения ионов Er³⁺ в SiO₂ с нанокристаллами Si.** А.А. Прокофьев, А.С. Москаленко, И.Н. Ясевич 8 985
- Релаксационные процессы в проводимости кристаллов Cd_{1-x}Mn_xTe (0.02 < x < 0.55).** Е.С. Никонюк, З.И. Захарук, М.И. Кучма, В.Л. Шляховый, А.И. Раренко, И.Н. Юрийчук 9 1028
- Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния.** Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, В.А. Володин 9 1145
- О параметрах образования вакансий в кристаллах подгруппы углерода.** М.Н. Магомедов 10 1153
- Проявление в функции Гоффмана особенностей генерационно-рекомбинационных свойств бистабильных дефектов в полупроводниках.** А.Г. Никитина, В.В. Зуев 10 1190
- Расчет электрической емкости самокомпенсированных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами).** Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А.Г. Забродский 12 1420
- Электрические свойства гетероэпитаксиальных слоев HgCdTe n-типа проводимости, модифицированных ионным травлением.** М. Поцяск, И.И. Ижнин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский . 12 1444
- Рост слитков карбида кремния политипа 4H на затравках с плоскостью (10 $\bar{1}0$).** Д.Д. Авров, А.В. Булатов, С.И. Дорожкин, А.О. Лебедев, Ю.М. Таиров 12 1483
- 4.1.5. Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)**
- Электрофизические свойства облученного протонами CdSnAs₂.** В.Н. Брудный, Т.В. Ведерникова 1 36
- Высокотемпературные матрицы детекторов ядерного излучения на основе 4H-SiC ионно-легированных p⁺-n-переходов.** Е.В. Калинина, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Ситникова, А.В. Садохин, А.Ю. Азаров, В.Г. Коссов, Р.Р. Яфаев 1 87
- Бистабильные амфотерные центры в полупроводнике.** А.Г. Никитина, В.В. Зуев 2 141
- Исследование проводимости сверхтонких пленок бифталоцианина олова.** Н.Л. Левшин, Н.Н. Пронин, П.А. Форш, С.Г. Юдин 2 199
- Влияние электронного облучения на скорость удаления носителей в кремнии и карбиде кремния модификации 4H.** В.В. Козловский, В.В. Емцев, К.В. Емцев, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, В.Н. Ломасов, Г.А. Оганесян, А.А. Лебедев 2 243
- Влияние процесса плавления на акустический отклик соединений CdTe и GaAs при импульсном лазерном облучении.** А. Байдуллаева, В.П. Велещук, А.И. Власенко, Б.К. Даулетмуратов, О.В. Ляшенко, П.Е. Мозоль 3 286
- Эффективная генерация первой волноводной моды в гетеролазере InGaAs/GaAs/InGaP.** А.А. Бирюков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, В.Я. Алёшкин, А.А. Дубинов, В.В. Кочаровский, Вл.В. Кочаровский 3 361

- Влияние облучения электронами и протонами на характеристики поверхностно-барьерных структур SiC-детекторов ядерных излучений.** А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, В.В. Козловский, А.А. Лебедев 3 370
- Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS.** Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин 4 399
- Кинетика формирования различных типов водород-содержащих доноров в кремнии, имплантированном протонами.** Ю.М. Покотило, А.Н. Петух, О.А. Дзичковский 7 893
- Особенности использования широкозонных полупроводниковых материалов в задачах регистрации ядерного излучения.** А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, А.А. Лебедев 9 1135
- Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния.** Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, В.А. Володин 9 1145
- Проявление в функции Гофмана особенностей генерационно-рекомбинационных свойств бистабильных дефектов в полупроводниках.** А.Г. Никитина, В.В. Зуев 10 1190
- Особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS.** Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая 10 1263
- Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ.** З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк 11 1321
- Электрические свойства гетероэпитаксиальных слоев HgCdTe *n*-типа проводимости, модифицированных ионным травлением.** М. Поцяск, И.И. Ижнин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский . 12 1444
- К вопросу радиационной стойкости SiC при чередовании стадий облучения и отжига.** А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, А.А. Лебедев 12 1466
- 4.2. Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)**
- Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников.** И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь 2 208
- Гибридно-фононные резонансы в квантовом канале.** В.В. Карпунин, В.А. Маргулис 6 711
- Релаксация возбужденных состояний доноров в кремнии с излучением междолинных фононов.** В.В. Цыпленков, Е.В. Демидов, К.А. Ковалевский, В.Н. Шасти 9 1032
- Инфракрасные спектры отражения многослойных эпитаксиальных гетероструктур с погруженными слоями InAs и GaAs.** П.В. Середин, Э.П. Домашевская, А.Н. Лукин, И.Н. Арсентьев, Д.А. Винокуров, И.С. Тарасов 9 1072
- Расчеты из первых принципов фононных спектров сверхрешеток (GaP)_n(AlP)_m.** А.В. Кособуцкий, Е.Н. Малышева 10 1227
- 4.3. Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)**
- Действие мощных нано- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры.** Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann 2 181
- Вариация края поглощения света в пленках SiN_x с кластерами кремния.** М.Д. Ефремов, В.А. Володин, Д.В. Марин, С.А. Аржаникова, Г.Н. Камаев, С.А. Кочубей, А.А. Попов 2 202
- Влияние флуктуаций на электронные и фононные процессы и термодинамические параметры Ag₂Te и Ag₂Se в области фазового перехода.** С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев 4 404
- Термическая неустойчивость фуллеренов кремния, стабилизируемых водородом. Компьютерный эксперимент.** А.Е. Галашев 5 611
- Состав и параметры доменов, образующихся в результате спиноподобного распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах GaInP/Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}/GaInP/GaAs(001).** Э.П. Домашевская, Н.Н. Гордиенко, Н.А. Румянцева, П.В. Середин, Б.Л. Агапов, Л.А. Битюцкая, И.Н. Арсентьев, Л.С. Вавилова, И.С. Тарасов 9 1086
- Энергетический спектр носителей заряда в Ag₂Te.** С.А. Алиев, З.Ф. Агаев, Р.И. Селим-заде 12 1415
- 4.4. Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)**
- Расщепление пика натрия на динамических вольтамперных характеристиках конвективных ионных токов структур металл-окисел-полупроводник.** С.Г. Дмитриев, Ю.В. Маркин 1 45
- Влияние оже-рекомбинации на тепловую стабильность мощных высоковольтных полупроводниковых диодов.** Т.Т. Мнацаканов, М.Е. Левинштейн, А.С. Фрейдлин 2 220
- Диффузия хрома в эпитаксиальный арсенид галлия.** М.Д. Вилисова, Е.П. Другова, И.В. Пономарев, В.А. Чубирко 2 239
- Моделирование приповерхностной протонно-стимулированной диффузии бора в кремнии.** О.В. Александров, В.В. Козловский 3 262
- Особенности проявления акцепторного состояния золота в кремнии с термодонорами.** А.Д. Кирюхин, В.В. Григорьев, А.В. Зуев, В.В. Зуев 3 271
- Влияние состояния вакансионного равновесия на процесс диффузии примеси хрома в арсениде галлия.** С.С. Хлудков 3 378
- Residual resistance and Joule heat generation in bulk samples and nanostructures.** V. L. Gurevich 8 931
- О параметрах образования вакансий в кристаллах подгруппы углерода.** М.Н. Магомедов 10 1153
- Энергетический спектр носителей заряда в Ag₂Te.** С.А. Алиев, З.Ф. Агаев, Р.И. Селим-заде 12 1415
- Электрические свойства гетероэпитаксиальных слоев HgCdTe *n*-типа проводимости, модифицированных ионным травлением.** М. Поцяск, И.И. Ижнин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский . 12 1444

4.5. Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)

- Возможности и основные принципы управления пластической релаксацией пленок GeSi/Si и Ge/Si ступенчато изменяемого состава. Ю.Б. Болховитянов, А.К. Гутаковский, А.С. Дерябин, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов 1 3
- In situ* исследование кинетики формирования КТ InSb в матрице InAs(Sb). А.Н. Семенов, О.Г. Люблинская, В.А. Соловьев, Б.Я. Мельцер, С.В. Иванов 1 75
- Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин 1 101
- Исследование проводимости сверхтонких пленок бифталоцианина олова. Н.Л. Левшин, Н.Н. Пронин, П.А. Форш, С.Г. Юдин 2 199
- Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь 2 208
- Диффузия хрома в эпитаксиальный арсенид галлия. М.Д. Вилисова, Е.П. Другова, И.В. Пономарев, В.А. Чубирко 2 239
- Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя InAs. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин 3 303
- Влияние состояния вакансионного равновесия на процесс диффузии примеси хрома в арсениде галлия. С.С. Хлудков 3 378
- Влияние флуктуаций на электронные и фононные процессы и термодинамические параметры Ag₂Te и Ag₂Se в области фазового перехода. С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев 4 404
- Собственный окисел, возникающий на поверхности скола селенида галлия в результате длительного хранения. С.И. Драпак, С.В. Гаврилюк, З.Д. Ковалюк, О.С. Литвин 4 423
- Кинетика резистивного отклика тонких пленок SnO_{2-x} в газовой среде. С.В. Рябцев, А.В. Юкиш, С.И. Ханго, Ю.А. Юраков, А.В. Шапошник, Э.П. Домашевская 4 491
- Свойства пленок оксида цинка, синтезированных в низкотемпературном плазменном разряде в условиях бомбардировки компонентами плазмы. А.А. Сердобинцев, А.Г. Веселов, О.А. Кирысова 4 496
- Исследование самоорганизации неупорядоченных материалов с применением теории информации. Т.Г. Авачева, Н.В. Бодягин, С.П. Вихров, С.М. Мурсалов 5 513
- Сравнительный анализ механизмов формирования межфазной границы пленочной структуры в равновесных и резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов, Х.А. Тошходжаев 5 519
- Исследование свойств поверхности арсенида галлия методом сканирующей атомно-силовой микроскопии. В.Г. Божков, Н.А. Торхов, И.В. Ивонин, В.А. Новиков 5 546
- Критическая толщина перехода по Странскому–Крастанову с учетом эффекта сегрегации. Д.В. Юрасов, Ю.Н. Дроздов 5 579
- Рентгеноспектральный микроанализ полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур на основе моделирования транспорта электронов методом Монте-Карло. Т.Б. Попова, Л.А. Бакалейников, М.В. Заморянская, Е.Ю. Флегонтова 6 686
- Латеральное упорядочение нановискеров GaAs на поверхностях GaAs(111)В и GaAs(110) при молекулярно-пучковой эпитаксии. Г.Э. Цырлин, Н.В. Сибирев, С. Sartel, J.-C. Harmand 6 726
- Формирование сверхизлучения в наногетероструктурах с квантовыми точками. А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря 6 730
- CdTe как пассивирующий слой в гетероструктуре CdTe/HgCdTe. И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф.Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов 7 788
- Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности n-6H-SiC под воздействием сверхвысокочастотной обработки. Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин, О.Б. Охрименко, А.М. Светличный, В.В. Поляков 7 888
- Вызванные действием магнитного поля изменения примесного состава и микротвердости приповерхностных слоев кристаллов кремния. В.А. Макара, М.А. Васильев, Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, С.Н. Науменко 9 1061
- Адсорбция метилтиола на поверхности GaAs(100)-(2 × 4): квантово-химический анализ из первых принципов. М.В. Лебедев 9 1065
- Фотолюминесценция нанокластеров GeSi/Si, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа. Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов 9 1116
- Роль флуктуаций потенциала в энергетической структуре квантовых ям GaAs/AlGaAs с A⁺-центрами. П.В. Петров, Ю.Л. Иванов, В.С. Михрин, А.Е. Жуков 10 1219
- Расчеты из первых принципов фононных спектров сверхрешеток (GaP)_n(AlP)_m. А.В. Кособуцкий, Е.Н. Мальшева 10 1227
- О зависимости высоты нитевидных нанокристаллов GaAs от скорости осаждения. Н.В. Сибирев, В.Г. Дубровский, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Ю.Б. Самсоненко, В.М. Устинов 11 1286
- Статические вольт-амперные характеристики туннельных МДП структур Au/CaF₂/n-Si(111). С.М. Сутурин, А.Г. Банщикова, Н.С. Соколов, С.Э. Тягинов, М.И. Векслер 11 1333
- Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaN для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмонослойной дискретной молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота. В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, А.В. Сахаров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, С.В. Иванов, Е.В. Луценко, А.В. Данильчик, Н.В. Ржеуцкий, Г.П. Яблонский 12 1452

- Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электроннолучевой накачкой на основе многослойных наноструктур $A^{IV}V^I$. М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, Д.В. Перегудов, В.Б. Студенов, И.В. Седова, С.В. Гронин, С.В. Сорокин, С.В. Иванов, П.С. Копьев 12 1472
- Особенности формирования нитевидных нанокристаллов GaAs на различных поверхностях кремния при молекулярно-пучковой эпитаксии. Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, В.П. Улин, В.Г. Дубровский 12 1478

5. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)

- Лазерно-стимулированная модификация примесного энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Волинская 4 385

5.1. Электронные состояния (PACS 71)

- Оптическая спектроскопия свободных экситонов в халькопиритном полупроводниковом соединении $CuInS_2$. А.В. Мудрый, А.В. Иванюкович, М.В. Якушев, Р. Мартин, А. Саад 1 31
- Фазовый состав пленок системы Bi-S и формирование Bi_2S_3 с различной субструктурой. Г.М. Ахмедов 2 129
- Роль фоновых примесей O и Cu в оптике кристаллов ZnSe с позиций теории непересекающихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, Е.М. Гавришук, В.Г. Галстян 2 131
- Оптические свойства твердых растворов $AgGa_xIn_{1-x}Se_2$. И.В. Боднар 2 153
- Особенности проявления акцепторного состояния золота в кремнии с термодонорами. А.Д. Кирюхин, В.В. Григорьев, А.В. Зуев, В.В. Зуев 3 271
- Лазерно-стимулированная модификация примесного энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Волинская 4 385
- Магнитная восприимчивость твердых растворов $Bi_2Te_3-Sb_2Te_3$. Н.П. Степанов, А.К. Гильфанов, Л.Д. Иванова, Ю.В. Гранаткина 4 410
- Влияние температуры и интенсивности освещения на образование метастабильных состояний в $a-Si:H$. И.А. Курова, Н.Н. Ормонт 4 447
- O волновых функциях горячих экситонов в полупроводниках с вырожденными зонами. А.В. Ефанов . . 6 658
- Механизм локальной аморфизации сильно легированного интерметаллического полупроводника $Ti_{1-x}V_xCoSb$. В.А. Ромака, Ю.В. Стаднык, Л.Г. Аксельруд, В.В. Ромака, D. Fruchart, P. Rogl, В.Н. Давыдов, Ю.К. Гореленко 7 769
- Влияние кислорода на структуру и электронные свойства нанокластеров кремния Si_n ($n = 5, 6, 10, 18$). А.А. Гниденко, В.Г. Заводинский 7 817
- Релаксация экситонов в полумагнитных асимметричных двойных квантовых ямах. С.В. Зайцев, А.С. Бричкин, П.С. Дорожкин, G. Vacher 7 831

- Примесные резонансные состояния в полупроводниках. В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко, М.А. Одноблюдов, И.Н. Ясевич 8 899
- Side jump contribution to spin-orbit mediated Hall effects and Berry curvature. E.I. Rashba 8 923
- Superfluid-insulator transition in dirty ultracold Fermi gas. B.I. Shklovskii 8 927
- O роли экранирования электрон-фононного взаимодействия в релаксации фотовозбужденной электронно-дырочной плазмы в полупроводнике. С.Е. Кумекон 8 938
- Transmission distribution, $\mathcal{P}(\ln T)$, of 1D disordered chain: low- T tail. V.M. Apalkov, M.E. Raikh 8 956
- Boundary instability of a two-dimensional electron fluid. M.I. Dyakonov 8 998
- Spin-orbit terms in multi-subband electron systems: A bridge between bulk and two-dimensional Hamiltonians. K.V. Kavokin, M.E. Portnoi 8 1002
- Relaxation processes in a disordered Luttinger liquid. D.A. Bagrets, I.V. Gornyi, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov 8 1007
- Фазообразование и фазовые превращения в нанотолщинных пленках системы Bi-Te. Г.М. Ахмедов . . 9 1025
- Особенности спектров люминесценции кристаллов ZnS(O) и ZnS·Cu(O) с позиций теории непересекающихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, В.Г. Галстян, Е.М. Гавришук 9 1039
- Исследование монокристаллов тройного соединения $CuIn_3Se_5$. И.В. Боднар 9 1046
- Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Бронева, А.Н. Кривоносос, Т.А. Налет 9 1053
- Влияние фазового перехода на энергетический спектр электронов в Ag_2S . Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров, Б.А. Таиров, Г.П. Пашаев, А.А. Садинова, А.А. Кулиев 10 1165
- Число Лоренца и фактор Холла в вырожденных полупроводниках при резонансном рассеянии носителей тока. Л.В. Прокофьева, А.А. Шабалдин, В.А. Корчагин, С.А. Немов, Ю.И. Равич 10 1180
- Исследование свойств эпитаксиального и слиткового антимолида галлия. В.П. Хвостиков, С.В. Сорокина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев 10 1198
- Высококочувствительный субмиллиметровый фотоприемник на основе InSb. Ю.Б. Васильев, А.А. Усикова, Н.Д. Ильинская, П.В. Петров, Ю.Л. Иванов 10 1253
- Электронный парамагнитный резонанс взаимодействующих спинов в $n-Ge$. II. Изменение ширины и формы линий. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек, С.И. Голощапов 11 1301
- Расчет электрической емкости самокомпенсированных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами). Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А.Г. Забродский 12 1420

5.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)

- Роль фоновых примесей O и Cu в оптике кристаллов ZnSe с позиций теории непересекающихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, Е.М. Гавришук, В.Г. Галстян 2 131

- Пространственное распределение дефектов и кинетика неравновесных носителей заряда в вюрцитных кристаллах GaN, легированных Sm, Eu, Er, Tm и дополнительно введенной примесью Zn. М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова 2 157
- Ионизация в электрическом поле DX-центра, связанного с серой, в $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{P}$. Ю.К. Крутоголов 2 171
- Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь 2 208
- Особенности проявления акцепторного состояния золота в кремнии с термодонорами. А.Д. Кирюхин, В.В. Григорьев, А.В. Зуев, В.В. Зуев 3 271
- Влияние ультразвуковой обработки на фотоэлектрические и люминесцентные свойства кристаллов ZnSe. Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, Ф.С. Габиров, И.К. Камиллов, Ф.И. Маняхин, Е.К. Наими 3 282
- Определение энергии и концентрации амфотерных дефектов методом дифференциальной обработки температурной зависимости концентрации свободных носителей. А.Г. Никитина, В.В. Зуев 4 389
- Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Си монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин 4 399
- Влияние температуры и интенсивности освещения на образование метастабильных состояний в $\alpha\text{-Si}$:Н. И.А. Курова, Н.Н. Ормонт 4 447
- Разработка фотоприемников для преобразователей изображений: легирование кремния селеном из газовой фазы. Ю.А. Астров, В.Б. Шуман, А.Н. Лодыгин, Л.М. Порцель, А.Н. Махова 4 457
- У- и Z-люминесценция поликристаллического теллурида кадмия, полученного неравновесной реакцией прямого синтеза компонентов. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 5 536
- Собственная люминесценция Tb в металл-полимерных комплексах полиамидокислот. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, С.Е. Никитин, П.А. Форш, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский 5 618
- Электронные характеристики однократно ионизированной пары доноров фосфора в кремнии и операции с зарядовыми кубитами. А.Н. Воронько 6 672
- Особенности долговременной релаксации емкости в выпрямляющих структурах на основе монокристаллического ZnP_2 n -типа проводимости. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко 6 679
- Особенности спектров люминесценции кристаллов $\text{ZnS}(\text{O})$ и $\text{ZnS}\cdot\text{Cu}(\text{O})$ с позиций теории пересекающихся зон. Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, В.Г. Галстян, Е.М. Гавришук 9 1039
- Проявление в функции Гоффмана особенностей генерационно-рекомбинационных свойств бистабильных дефектов в полупроводниках. А.Г. Никитина, В.В. Зуев 10 1190
- Сравнительный анализ предельной эффективности фотопреобразования обычных солнечных элементов и солнечных элементов с квантовыми ямами. А.В. Саченко, И.О. Соколовский 10 1238
- Высокочувствительный субмиллиметровый фотоприемник на основе InSb. Ю.Б. Васильев, А.А. Усикова, Н.Д. Ильинская, П.В. Петров, Ю.Л. Иванов 10 1253
- Электрические свойства, фотопроводимость и фотолуминесценция крупнозернистого $p\text{-ZnTe}$. Ю.В. Клевков, С.А. Колосов, В.С. Кривобок, В.П. Марговицкий, С.Н. Николаев 11 1291
- Расчет электрической емкости самокомпенсированных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами). Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А.Г. Забродский 12 1420
- ## 5.2. Транспортные явления (PACS 72)
- Электрофизические свойства облученного протонами CdSnAs_2 . В.Н. Брудный, Т.В. Ведерникова 1 36
- О предельных значениях добротности термоэлектрических композитов. А.А. Снарский, М.И. Женировский, И.В. Безсуднов 1 82
- Электрические свойства слоистых монокристаллов FeIn_2Se_4 на переменном токе. Н.Н. Нифтиев, О.Б. Тагиев, М.Б. Мурадов 3 268
- Оптическая ориентация дырок в деформированных наноструктурах. Н.С. Аверкиев, Н.И. Саблина 3 316
- Влияние флуктуаций на электронные и фононные процессы и термодинамические параметры Ag_2Te и Ag_2Se в области фазового перехода. С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев 4 404
- Примесная проводимость монокристаллов $\text{Hg}_3\text{In}_2\text{Te}_6$. Л.А. Косяченко, И.И. Герман, И.М. Раренко, З.И. Захарук, Е.С. Николюк 5 528
- Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов $\text{Ga}_x\text{Se}_{1-x}$. А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.Г. Мохтари, В.В. Дадашова, А.А. Агаева 5 532
- О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах $n\text{-InGaAs/GaAs}$ с квантовыми ямами. П.А. Белевский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, И.В. Строганова 5 604
- Собственная люминесценция Tb в металл-полимерных комплексах полиамидокислот. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, С.Е. Никитин, П.А. Форш, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский 5 618
- Исследование зависимости электрофизических параметров пленок $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, от уровня легирования индием. В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Д.Г. Икусов, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, Г.Ю. Сидоров, М.В. Якушев 6 664
- Исследование влияния температуры крекинга мышьяка на эффективность его встраивания в пленки CdHgTe в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии. Г.Ю. Сидоров, Н.Н. Михайлов, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Ю.Г. Сидоров, С.А. Дворецкий 6 668
- CdTe как пассивирующий слой в гетероструктуре CdTe/HgCdTe. И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф.Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов 7 788

- Обменное усиление g -фактора в гетероструктурах InAs/AlSb. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, А.В. Иконников, С.С. Криштопенко, Ю.Г. Садофьев, К.Е. Спирин 7 846
- Side jump contribution to spin-orbit mediated Hall effects and Berry curvature. E.I. Rashba 8 923
- Transmission distribution, $\mathcal{P}(\ln T)$, of 1D disordered chain: low- T tail. V.M. Apalkov, M.E. Raikh 8 956
- Thermal orientation of electron spins. S.A. Tarasenko 8 982
- Процессы возбуждения ионов Er^{3+} в SiO_2 с нанокристаллами Si. А.А. Прокофьев, А.С. Москаленко, И.Н. Ясневич 8 985
- Число Лоренца и фактор Холла в вырожденных полупроводниках при резонансном рассеянии носителей тока. Л.В. Прокофьева, А.А. Шабалдин, В.А. Корчагин, С.А. Немов, Ю.И. Равич 10 1180
- Энергетический спектр носителей заряда в Ag_2Te . Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров 11 1297
- Свойства МДП структур на основе варизонного HgCdTe , выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, С.М. Дзядух, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.В. Васильев 11 1327
- 5.2.1. Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)**
- Линейная стадия эволюции электронно-дырочных лавин в полупроводниках. А.С. Кюрегян 1 23
- Электрофизические свойства облученного протонами CdSnAs_2 . В.Н. Брудный, Т.В. Ведерникова 1 36
- Фоточувствительность пленок $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$ в области собственного поглощения. А.Э. Климов, В.Н. Шумский 2 147
- Высоковольтные (900 В) 4H-SiC диоды Шоттки с охранным $p-n$ -переходом, изготовленным имплантацией бора. И.В. Грехов, П.А. Иванов, Н.Д. Ильинская, О.И. Коньков, А.С. Потапов, Т.П. Самсонова 2 211
- Электрические свойства слоистых монокристаллов FeIn_2Se_4 на переменном токе. Н.Н. Нифтиев, О.Б. Тагиев, М.Б. Мурадов 3 268
- Особенности проявления акцепторного состояния золота в кремнии с термодонорами. А.Д. Кирюхин, В.В. Григорьев, А.В. Зуев, В.В. Зуев 3 271
- Поляризационная пьезоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы $\text{GaAs}/\text{Al}_{0.35}\text{Ga}_{0.65}\text{As}:\text{Be}$. Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов 3 322
- Лазерно-стимулированная модификация примесного энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Вольнская 4 385
- Определение энергии и концентрации амфотерных дефектов методом дифференциальной обработки температурной зависимости концентрации свободных носителей. А.Г. Никитина, В.В. Зуев 4 389
- Влияние поперечного магнитного поля на поведение продольных автосолитонов в $p\text{-InSb}$. И.К. Камиллов, А.А. Степуренко, А.Э. Гумметов, А.С. Ковалев 4 393
- Влияние флуктуаций на электронные и фононные процессы и термодинамические параметры Ag_2Te и Ag_2Se в области фазового перехода. С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев 4 404
- Примесная проводимость монокристаллов $\text{Hg}_3\text{In}_2\text{Te}_6$. Л.А. Косяченко, И.И. Герман, И.М. Раренко, З.И. Захарук, Е.С. Николюк 5 528
- Механизм локальной аморфизации сильно легированного интерметаллического полупроводника $\text{Ti}_{1-x}\text{V}_x\text{CoSb}$. В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, Л.Г. Аксельруд, В.В. Ромака, D. Fruchart, P. Rogl, В.Н. Давыдов, Ю.К. Гореленко 7 769
- Импульсный пробой диодов Шоттки на основе 4H-SiC с охранным $p-n$ -переходом, изготовленным имплантацией бора. П.А. Иванов, И.В. Грехов, А.С. Потапов, Т.П. Самсонова 7 878
- Влияние магнитного поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода $n\text{-GaAs}-p\text{-Ge}$. М.М. Гаджиалиев, З.Ш. Пирмагомедов 9 1050
- Энергетический спектр носителей заряда в Ag_2Te . Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров 11 1297
- Электрические и гальваномангнитные свойства пленок теллурида кадмия, синтезированных в резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов, В.В. Гришин 11 1309
- Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк 11 1321
- Расчет электрической емкости самокомпенсированных полупроводников с межцентровыми прыжками одного и двух электронов (на примере кремния с радиационными дефектами). Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А.Г. Забродский 12 1420
- Разъединенный гетеропереход Π -типа $\text{GaSb}_{1-x}\text{As}_x/\text{InAs}$ ($x < 0.15$): эволюция зонной энергетической диаграммы тройного твердого раствора. В.В. Романов, К.Д. Моисеев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Ю.П. Яковлев 12 1434
- 5.2.2. Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)**
- Лазерно-стимулированная модификация примесного энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Вольнская 4 385
- Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs . Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривоносос, Т.А. Налет 9 1053
- Влияние фазового перехода на энергетический спектр электронов в Ag_2S . Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров, Б.А. Таиров, Г.П. Пашаев, А.А. Садинова, А.А. Кулиев 10 1165
- Субтрагерцовые автоколебания в сверхбыстрой автомодуляции поглощения света в GaAs . Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривоносос 12 1426
- 5.2.3. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)**
- Фоточувствительность пленок $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$ в области собственного поглощения. А.Э. Климов, В.Н. Шумский 2 147

Влияние ультразвуковой обработки на фотоэлектрические и люминесцентные свойства кристаллов ZnSe. Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, Ф.С. Габитов, И.К. Камиллов, Ф.И. Маняхин, Е.К. Наими	3	282	Диагностика низкобарьерных диодов Шоттки с приповерхностным δ -легированием. В.И. Шашкин, А.В. Мурель	4	500
Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллических соединений $\text{AgCd}_2\text{GaS}_4$. Л.В. Булатецкая, В.В. Божко, Г.Е. Давидюк, О.В. Парасюк	5	522	Исследование свойств поверхности арсенида галлия методом сканирующей атомно-силовой микроскопии. В.Г. Божков, Н.А. Торхов, И.В. Ивонин, В.А. Новиков	5	546
Высококочувствительный субмиллиметровый фотоприемник на основе InSb. Ю.Б. Васильев, А.А. Усикова, Н.Д. Ильинская, П.В. Петров, Ю.Л. Иванов	10	1253	Резонансное туннелирование носителей в фотовозбужденных гетероструктурах 2-го типа ZnSe/BeTe. С.В. Зайцев, А.А. Максимов, И.И. Тартаковский, Д.Р. Яковлев, А. Ваг	5	555
Электрические свойства, фотопроводимость и фотолюминесценция крупнозернистого p -ZnTe. Ю.В. Клевков, С.А. Колосов, В.С. Кривобок, В.П. Мартовицкий, С.Н. Николаев	11	1291	Теоретическое исследование процессов ожереккомбинации в глубоких квантовых ямах. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря	5	566
Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк	11	1321	Пороговые характеристики ИК-лазера на основе глубоких квантовых ям InAsSb/AlSb. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря	5	573
5.3. Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)			О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах n-InGaAs/GaAs с квантовыми ямами. П.А. Белевский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, И.В. Строганова	5	604
Глубокие уровни и электронный транспорт в гетероструктурах AlGaIn/GaN. И.В. Антонова, В.И. Поляков, А.И. Руковишников, В.Г. Мансуров, К.С. Журавлев	1	53	О механизме токопереноса, обусловленном дислокациями в нитридгаллиевых диодах Шоттки. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, В.П. Кладько, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, А.В. Кучук, В.В. Миленин, Ю.Н. Свешников, В.Н. Шермет	6	706
Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин	1	101	Гибридно-фононные резонансы в квантовом канале. В.В. Карпунин, В.А. Маргулис	6	711
Фазовый состав пленок системы Bi-S и формирование Bi_2S_3 с различной субструктурой. Г.М. Ахмедов	2	129	Формирование сверхизлучения в наногетероструктурах с квантовыми точками. А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря	6	730
Фотопроводимость тонких пленок аморфного гидрированного кремния. А.Г. Казанский, О.Г. Кошелев, А.Ю. Сазонов, А.А. Хомич	2	192	Периодическое создание кратковременной инверсии населенностей на межподзонных лазерных переходах в квантовых ямах. В.А. Кукушкин	7	810
Снижение подвижности электронов в канале металл-окисел-полупроводник транзистора при уменьшении длины затвора. А.А. Французов, Н.И. Бояркина, В.П. Попов	2	215	Влияние кислорода на структуру и электронные свойства нанокластеров кремния Si_n ($n = 5, 6, 10, 18$). А.А. Гниденко, В.Г. Заводинский	7	817
Электрические свойства слоистых монокристаллов FeIn_2Se_4 на переменном токе. Н.Н. Нифтиев, О.Б. Тагиев, М.Б. Мурадов	3	268	Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов	7	823
Роль процессов переноса неравновесных носителей заряда в излучательных свойствах массивов InAs/GaAs-квантовых точек. А.С. Школьник, А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря, S. Pellegrini, G.S. Buller, В.П. Евтихий	3	296	Релаксация экситонов в полумагнитных асимметричных двойных квантовых ямах. С.В. Зайцев, А.С. Бречкин, П.С. Дорожкин, G. Vacher	7	831
Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя InAs. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин	3	303	Обменное усиление g -фактора в гетероструктурах InAs/AlSb. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, А.В. Иконников, С.С. Криштопенко, Ю.Г. Садофьев, К.Е. Спири	7	846
Эффект Ванье-Штарка в сверхрешетке квантовых точек Ge/Si. М.М. Соболев, Г.Э. Цырлин, А.А. Тонких, Н.Д. Захаров	3	311	Управление заселенностью верхней рабочей подзоны электрическим полем в структурах с асимметричными барьерами для униполярного лазера. Ю.А. Алещенко, А.Е. Жуков, В.В. Капаев, Ю.В. Капаев, П.С. Копьев, В.М. Устинов	7	856
Влияние условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия (IFO) на фотоэлектрические свойства гетероперехода IFO/ p -Si. Г.Г. Унтила, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха	4	415	Residual resistance and Joule heat generation in bulk samples and nanostructures. V. L. Gurevich	8	931
			Теория каталитической диссоциации атомов водорода на поверхности металла. О.В. Константинов, В.Д. Дымников, М.А. Митцев	8	947

- Magnetotransport in a 2D system with strong scatterers: renormalization of Hall coefficient caused by non-Markovian effects. *A.P. Dmitriev, V.Yu. Kachorovskii* . 8 950
- Особенности оптической ориентации и релаксации электронных спинов в квантовых ямах с большим спиновым расщеплением. *Н.С. Аверкиев, М.М. Глазов* 8 973
- Thermal orientation of electron spins. *S.A. Tarasenko* . 8 982
- Процессы возбуждения ионов Er^{3+} в SiO_2 с нанокристаллами Si. *А.А. Прокофьев, А.С. Москаленко, И.Н. Ясневич* 8 985
- Эффекты самосогласованного электростатического потенциала в квантовых ямах с несколькими уровнями размерного квантования в сильных магнитных полях. *А.А. Грешнов, Г.Г. Зегря* 8 994
- Spin-orbit terms in multi-subband electron systems: A bridge between bulk and two-dimensional Hamiltonians. *K.V. Kavokin, M.E. Portnoi* 8 1002
- Relaxation processes in a disordered Luttinger liquid. *D.A. Bagrets, I.V. Gornyi, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov* . 8 1007
- Фазообразование и фазовые превращения в нанотолщинных пленках системы Bi—Te. *Г.М. Ахмедов* . . 9 1025
- Барические свойства квантовых точек InAs. *Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелешак, О.О. Данькив, В.А. Гайсин, В.Г. Талалаев, И.В. Штром, Г.Э. Цырлин* . 9 1094
- Электрофизические и структурные свойства двусторонне δ -легированных PHEMT-гетероструктур на основе AlGaAs/InGaAs/AlGaAs. *И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, В.Г. Мокеров, С.С. Широков, Р.М. Имамов, И.А. Субботин* 9 1102
- Эмиссия электронов из многослойных ансамблей вертикально связанных квантовых точек InAs в матрице n -GaAs . *А.А. Гуткин, П.Н. Брунков, А.Ю. Егоров, А.Е. Жуков, С.Г. Конников* 9 1122
- Исследование свойств эпитаксиального и слиткового антимонида галлия. *В.П. Хвостиков, С.В. Сорокина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев* 10 1198
- Учет спонтанной поляризации в задаче о гетероструктуре NH -SiC/ $3C$ -SiC/ NH -SiC, образованной кубическим ($3C$) и гексагональными (NH) поли типами карбида кремния. *С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин* 10 1206
- Роль флуктуаций потенциала в энергетической структуре квантовых ям GaAs/AlGaAs с A^+ -центрами. *П.В. Петров, Ю.Л. Иванов, В.С. Михрин, А.Е. Жуков* 10 1219
- Влияние примесей на постоянную составляющую тока в квантовой нити в условиях совместного воздействия постоянного и переменного электрических полей. *Д.В. Завьялов, С.В. Крючков* 10 1223
- Сравнительный анализ предельной эффективности фотопреобразования обычных солнечных элементов и солнечных элементов с квантовыми ямами. *А.В. Саченко, И.О. Соколовский* 10 1238
- Каталитические свойства композитных слоев аморфный углерод—платина в топливных элементах. *А.А. Нечитайлов, Т.К. Звонарева, А.Д. Ременюк, В.А. Толмачев, Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, Л.В. Беляков, О.М. Сресели* 10 1268
- Роль спонтанной поляризации в формировании структур NH -SiC/ $3C$ -SiC/ NH -SiC на основе политипов карбида кремния. *С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин* . . . 11 1318
- Свойства МДП структур на основе варизонного HgCdTe, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. *А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, С.М. Дзядух, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.В. Васильев* 11 1327
- Решение задачи инжекции носителей тока в изолирующий слой при самосогласованных граничных условиях на контактах. *В.И. Шашкин, Н.В. Востоков* . 11 1339
- Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока. *Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Ключков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер* 11 1384
- Исследование промежуточного слоя на гетерогранице n^+ -CdS/ p -CdTe. *С.А. Музафарова, Б.У. Айтбаев, Ш.А. Мирсагатов, К. Дуршимбетов, Ж. Жанаберганов* 12 1409
- Электрические свойства гетероэпитаксиальных слоев HgCdTe n -типа проводимости, модифицированных ионным травлением. *М. Поляск, И.И. Ижнин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский* . 12 1444
- Энергия связи экситона и X^+ , X^- -трионов в одномерных системах. *М.А. Семина, Р.А. Сергеев, Р.А. Сурис* 12 1459
- 5.3.1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)**
- Зависимость изгиба зон на границе микроконтакта AgBr—AgI от формы и размера гетерогенной системы. *А.В. Ханефт, А.С. Поплавной, Б.А. Сечкарев, Л.В. Сотникова* 1 40
- Глубокие уровни и электронный транспорт в гетероструктурах AlGaN/GaN. *И.В. Антонова, В.И. Поляков, А.И. Руковишников, В.Г. Мансуров, К.С. Журавлев* 1 53
- Электрофизические свойства слоев Si:Er/Si, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии . *О.В. Белова, В.Н. Шабанов, А.П. Касаткин, О.А. Кузнецов, А.Н. Яблонский, М.В. Кузнецов, В.П. Кузнецов, А.В. Корнаухов, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник* 2 136
- Оптические свойства твердых растворов $AgGa_xIn_{1-x}Se_2$. *И.В. Боднар* 2 153
- Снижение подвижности электронов в канале металл—окисел—полупроводник транзистора при уменьшении длины затвора. *А.А. Французов, Н.И. Бояркина, В.П. Попов* 2 215
- О способах испарения Si и легирующих примесей в методах вакуумной эпитаксии. *В.П. Кузнецов, Н.А. Алябина, В.А. Боженкин, О.В. Белова, М.В. Кузнецов* 3 257
- Роль процессов переноса неравновесных носителей заряда в излучательных свойствах массивов InAs/GaAs-квантовых точек. *А.С. Школьник, А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря, S. Pellegrini, G.S. Buller, В.П. Евтихийев* 3 296
- Эффект Ванье—Штарка в сверхрешетке квантовых точек Ge/Si. *М.М. Соболев, Г.Э. Цырлин, А.А. Тонких, Н.Д. Захаров* 3 311

- Оптическая ориентация дырок в деформированных наноструктурах. *Н.С. Аверкиев, Н.И. Саблина* . . . 3 316
- Поляризационная пьезоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы $\text{GaAs}/\text{Al}_{0.35}\text{Ga}_{0.65}\text{As}$: *В. Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов* 3 322
- Механизм формирования отклика газового сенсора водорода на основе кремниевого МОП диода. *В.И. Гаман, В.И. Балюба, В.Ю. Грицык, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина* 3 341
- Высоочастотные свойства двухъямных наноструктур. *В.Ф. Елесин, И.Ю. Катеев* 5 586
- Гистерезис туннельного тока в двухбарьерных структурах $w\text{-GaN}/\text{AlGaN}(0001)$. *А.Н. Разжувалов, С.Н. Гриняев* 5 595
- Каскадный лазер на мелких донорах в δ -легированных сверхрешетках $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$. *Н.А. Бекин, В.Н. Шасти* 5 622
- Электронные характеристики однократно ионизированной пары доноров фосфора в кремнии и операции с зарядовыми кубитами. *А.Н. Воронько* 6 672
- О механизме токопереноса, обусловленном дислокациями в нитридгаллиевых диодах Шоттки. *А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, В.П. Кладько, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, А.В. Кучук, В.В. Миленин, Ю.Н. Свешников, В.Н. Шеремет* 6 706
- Формирование сверхизлучения в наногетероструктурах с квантовыми точками. *А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря* 6 730
- CdTe как пассивирующий слой в гетероструктуре $\text{CdTe}/\text{HgCdTe}$. *И.С. Вирт, И.В. Курило, И.А. Рудый, Ф.Ф. Сизов, Н.Н. Михайлов, Р.Н. Смирнов* 7 788
- Нановключения InGaN в матрице AlGaIn . *В.С. Сизов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин* 7 804
- Релаксация экситонов в полумагнитных асимметричных двойных квантовых ямах. *С.В. Зайцев, А.С. Бричкин, П.С. Дорожкин, G. Bacher* 7 831
- Обменное усиление g -фактора в гетероструктурах InAs/AlSb . *В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, А.В. Иконников, С.С. Криштопенко, Ю.Г. Садофьев, К.Е. Спирин* 7 846
- Теория каталитической диссоциации атомов водорода на поверхности металла. *О.В. Константинов, В.Д. Дымников, М.А. Митцев* 8 947
- Transmission distribution, $\mathcal{P}(\ln T)$, of 1D disordered chain: low- T tail. *В.М. Apalkov, М.Е. Raikh* 8 956
- Relaxation processes in a disordered Luttinger liquid. *D.A. Bagrets, I.V. Gornyi, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov* 8 1007
- Учет спонтанной поляризации в задаче о гетероструктуре $\text{NH-SiC}/3\text{C-SiC}/\text{NH-SiC}$, образованной кубическим (3С) и гексагональными (NH) политипами карбида кремния. *С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин* 10 1206
- Роль спонтанной поляризации в формировании структур $\text{NH-SiC}/3\text{C-SiC}/\text{NH-SiC}$ на основе политипов карбида кремния. *С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин* 11 1318
- Свойства МДП структур на основе варизонного HgCdTe , выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. *А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, С.М. Дзядух, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.В. Васильев* 11 1327
- Разъединенный гетеропереход II -типа $\text{GaSb}_{1-x}\text{As}_x/\text{InAs}$ ($x < 0.15$): эволюция зонной энергетической диаграммы тройного твердого раствора. *В.В. Романов, К.Д. Моисеев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Ю.П. Яковлев* 12 1434
- Поверхностные состояния на границе раздела $n\text{-InN}$ -электролит. *А.А. Гуткин, М.Э. Рудинский, П.Н. Брунков, А.А. Клочихин, В.Ю. Давыдов, H.-Y. Chen, S. Gwo* 12 1448
- 5.3.2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30)**
- Оптические свойства твердых растворов $\text{AgGa}_x\text{In}_{1-x}\text{Se}_2$. *И.В. Боднар* 2 153
- Диагностика низкобарьерных диодов Шоттки с приповерхностным δ -легированием. *В.И. Шашкин, А.В. Мурель* 4 500
- Особенности долговременной релаксации емкости в выпрямляющих структурах на основе моноклинного ZnP_2 n -типа проводимости. *И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко* 6 679
- Свойства барьерных контактов к InP с наноразмерными слоями TlV_x . *И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль, И.С. Тарасов, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Е. Беляев, А.Б. Камалов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, Е.В. Руссу* 7 793
- Влияние электрического поля на фотоэффект в барьерах Шоттки на электронном дифосфиде кадмия. *И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко* 9 1079
- Структурные и энергетические характеристики собственных дефектов вакансионного типа в двуоснонапряженной решетке GaN . *Т.В. Безъязычная, В.М. Зеленковский, А.Л. Гурский, Г.И. Рябцев* 11 1281
- Решение задачи инжекции носителей тока в изолирующий слой при самосогласованных граничных условиях на контактах. *В.И. Шашкин, Н.В. Востоков* 11 1339
- Оптические свойства голубых светодиодов в системе $\text{InGaIn}/\text{GaIn}$ при высокой плотности тока. *Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер* 11 1384
- Быстрые оптические регистрирующие среды на полупроводниковых наноструктурах для записи и обработки изображений. *П.Г. Кашерининов, А.А. Томасов* 11 1391
- 5.3.3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)**
- Зависимость изгиба зон на границе микроконтакта $\text{AgBr}-\text{AgI}$ от формы и размера гетерогенной системы. *А.В. Хансфгт, А.С. Поплавной, Б.А. Сечкарев, Л.В. Сотникова* 1 40
- Глубокие уровни и электронный транспорт в гетероструктурах $\text{AlGaIn}/\text{GaIn}$. *И.В. Антонова, В.И. Поляков, А.И. Руковишников, В.Г. Мансуров, К.С. Журавлев* 1 53
- Восстановление профиля потенциала в изолирующем слое по вольт-амперным характеристикам туннельных МДП диодов. *Е.И. Гольдман, А.Г. Ждан, Н.Ф. Кухарская, М.В. Черняев* 1 94

- Электрофизические свойства слоев Si:Er/Si, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии. О.В. Белова, В.Н. Шабанов, А.П. Касаткин, О.А. Кузнецов, А.Н. Яблонский, М.В. Кузнецов, В.П. Кузнецов, А.В. Корнаухов, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник 2 136
- Снижение подвижности электронов в канале металл–окисел–полупроводник транзистора при уменьшении длины затвора. А.А. Французов, Н.И. Бояркина, В.П. Попов 2 215
- О способах испарения Si и легирующих примесей в методах вакуумной эпитаксии. В.П. Кузнецов, Н.А. Алябина, В.А. Боженкин, О.В. Белова, М.В. Кузнецов 3 257
- Сравнительный анализ фото- и электролюминесценции многослойных структур с самоформирующимися островками Ge(Si)/Si(001). Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, К.Е. Кудрявцев, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, М.В. Шалеев, Д.В. Шенгуров, В.Б. Шмагин, А.Н. Яблонский 3 291
- Механизм формирования отклика газового сенсора водорода на основе кремниевого МОП диода. В.И. Гаман, В.И. Балюба, В.Ю. Грицык, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина 3 341
- Electrical properties of InP/InGaAs *pnp* heterostructure–emitter bipolar transistor. Jung-Hui Tsai, Wen-Chau Liu, Der-Feng Guo, Yu-Chi Kang, Shao-Yen Chiu, Wen-Shiung Lour 3 353
- Влияние условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия (IFO) на фотоэлектрические свойства гетероперехода IFO/*p*-Si. Г.Г. Унтила, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха 4 415
- Собственный окисел, возникающий на поверхности скола селенида галлия в результате длительного хранения. С.И. Драпак, С.В. Гаврилюк, З.Д. Ковалюк, О.С. Литвин 4 423
- Термостойкий диод Шоттки TiV_x–*n*-GaP. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Б. Камалов, Л.М. Капитанчук, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, М.У. Насыров 4 463
- Диагностика низкобарьерных диодов Шоттки с приповерхностным δ -легированием. В.И. Шашкин, А.В. Мурель 4 500
- Резонансное туннелирование носителей в фотовозбужденных гетероструктурах 2-го типа ZnSe/BeTe. С.В. Зайцев, А.А. Максимов, И.И. Тартаковский, Д.Р. Яковлев, А. Вагг 5 555
- Гистерезис туннельного тока в двухбарьерных структурах *w*-GaN/AlGaN(0001). А.Н. Разжувалов, С.Н. Гриняев 5 595
- Особенности долговременной релаксации емкости в выпрямляющих структурах на основе монокристаллического ZnP₂ *n*-типа проводимости. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко 6 679
- Релаксация параметров тонкопленочных электролюминесцентных структур на основе ZnS:Mn при выключении. Н.Т. Гурин, О.Ю. Сабитов 6 692
- О механизме токопереноса, обусловленном дислокациями в нитридагалиевых диодах Шоттки. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, В.П. Кладько, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, А.В. Кучук, В.В. Миленин, Ю.Н. Свешников, В.Н. Шеремет 6 706
- Свойства барьерных контактов к InP с наноразмерными слоями TiV_x. И.Н. Арсентьев, А.В. Бобиль, И.С. Тарасов, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Е. Беляев, А.Б. Камалов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, Е.В. Руссу 7 793
- Адмитанс и нелинейная емкость многослойной структуры металл–полупроводник. Н.В. Востоков, В.И. Шашкин 7 799
- Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов 7 823
- Measurement and comparison of silicon *p-i-n* photodiodes ac impedance at different voltages. S. Özden, H. Bayhan, A. Dönmez, M. Bayhan 7 852
- Magnetotransport in a 2D system with strong scatterers: renormalization of Hall coefficient caused by non-Markovian effects. A.P. Dmitriev, V.Yu. Kachorovskii 8 950
- Влияние магнитного поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода *n*-GaAs–*p*-Ge. М.М. Гаджиалиев, З.Ш. Пирмагомедов 9 1050
- Влияние электрического поля на фотоэффект в барьерах Шоттки на электронном дифосфиде кадмия. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко 9 1079
- Автосолитоны в бистабильной системе кремния с глубокими примесными уровнями. А.М. Мусаев 10 1168
- Электрические и фотоэлектрические характеристики структур на основе слоистых полупроводников InSe и GaSe при облучении электронами с энергией 12.5 МэВ. З.Д. Ковалюк, О.А. Политанская, О.Н. Сидор, В.Т. Маслюк 11 1321
- Свойства МДП структур на основе варизонного HgCdTe, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, С.М. Дзялук, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, В.В. Васильев 11 1327
- Статические вольт-амперные характеристики туннельных МДП структур Au/CaF₂/*n*-Si(111). С.М. Сутурин, А.Г. Банщиков, Н.С. Соколов, С.Э. Тягинов, М.И. Векслер 11 1333
- Решение задачи инжекции носителей тока в изолирующий слой при самосогласованных граничных условиях на контактах. В.И. Шашкин, Н.В. Востоков 11 1339
- Зависимость механизма протекания тока в сплавленном омическом контакте In–*n*-GaN от концентрации основных носителей заряда. В.Н. Бессолов, Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг, О.В. Константинов, Е.А. Поссе 11 1345
- Особенности световых вольт-амперных характеристик *p-i-n*-структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса темнового тока. А.А. Андреев 11 1363
- Особенности вольт-фарадных характеристик МОП структур, обусловленные зарядом в окисле. Е.А. Боброва, Н.М. Омеляновская 11 1380
- Исследование промежуточного слоя на гетерогранице *n*⁺-CdS/*p*-CdTe. С.А. Музафарова, Б.У. Айтбаев, Ш.А. Мирсагатов, К. Дуршимбетов, Ж. Жанабергенов 12 1409

- Разъединенный гетеропереход П-типа GaSb_{1-x}As_x/InAs ($x < 0.15$): эволюция зонной энергетической диаграммы тройного твердого раствора. В.В. Романов, К.Д. Моисеев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Ю.П. Яковлев 12 1434
- Гигантский всплеск ударной ионизации в $p-n$ -переходе политипа 6H-SiC. В.И. Санкин, П.П. Шкробий 12 1439
- Поверхностные состояния на границе раздела n -InN-электролит. А.А. Гуткин, М.Э. Рудинский, П.Н. Брунков, А.А. Клочихин, В.Ю. Давыдов, H.-Y. Chen, S. Gwo 12 1448
- 5.3.4. Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)**
- Фотопроводимость тонких пленок аморфного гидрированного кремния. А.Г. Казанский, О.Г. Кошелев, А.Ю. Сазонов, А.А. Хомич 2 192
- Исследование проводимости сверхтонких пленок бифталоцианина олова. Н.Л. Левшин, Н.Н. Пронин, П.А. Форш, С.Г. Юдин 2 199
- Некоторые аспекты подбора примесей, улучшающих фотоэлектрические характеристики халькогенидных стеклообразных полупроводников. И.И. Бурдиян, В.В. Косюк, Р.А. Пынзарь 2 208
- Низкотемпературные аномалии фотоэлектромагнитного эффекта в p -Cd_xHg_{1-x}Te, обусловленные перезарядкой поверхностных состояний. С.Г. Гасанзаде, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский 4 431
- Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов GaS_xSe_{1-x}. А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.Г. Мохтари, В.В. Дадашова, А.А. Агаева 5 532
- Гистерезис туннельного тока в двухбарьерных структурах w -GaN/AlGaN(0001). А.Н. Разжувалов, С.Н. Гриняев 5 595
- О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах n -InGaAs/GaAs с квантовыми ямами. П.А. Белевский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, И.В. Строганова 5 604
- Magnetotransport in a 2D system with strong scatterers: renormalization of Hall coefficient caused by non-Markovian effects. A.P. Dmitriev, V.Yu. Kachorovskii 8 950
- Влияние электрического поля на фотоэффект в барьерах Шоттки на электронном дифосфиде кадмия. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко 9 1079
- Электрофизические и структурные свойства двусторонне δ -легированных PHEMT-гетероструктур на основе AlGaAs/InGaAs/AlGaAs. И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, В.Г. Мокеров, С.С. Широков, Р.М. Имамов, И.А. Субботин 9 1102
- Влияние фазового перехода на энергетический спектр электронов в Ag₂S. Ф.Ф. Алиев, М.Б. Джафаров, Б.А. Таиров, Г.П. Пашасев, А.А. Саддинова, А.А. Кулиев 10 1165
- Особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально не легированных и легированных Си монокристаллов CdS. Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая 10 1263
- Каталитические свойства композитных слоев аморфный углерод-платина в топливных элементах. А.А. Нечитайлов, Т.К. Звонарева, А.Д. Ременюк, В.А. Толмачев, Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, Л.В. Беляков, О.М. Сресели 10 1268
- Электрические и гальваномагнитные свойства пленок теллурида кадмия, синтезированных в резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов, В.В. Гришин 11 1309
- Особенности световых вольт-амперных характеристик $p-i-n$ -структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса темного тока. А.А. Андреев 11 1363
- Гигантский всплеск ударной ионизации в $p-n$ -переходе политипа 6H-SiC. В.И. Санкин, П.П. Шкробий 12 1439
- 5.4. Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)**
- О предельных значениях добротности термоэлектрических композитов. А.А. Снарский, М.И. Женировский, И.В. Безсуднов 1 82
- Лазерно-стимулированная модификация примесного энергетического спектра селенида галлия, интеркалированного кобальтом. И.И. Грыгорчак, А.И. Пелехович, Н.В. Волынская 4 385
- Магнитная восприимчивость твердых растворов Bi₂Te₃-Sb₂Te₃. Н.П. Степанов, А.К. Гильфанов, Л.Д. Иванова, Ю.В. Гранаткина 4 410
- Низкотемпературные аномалии фотоэлектромагнитного эффекта в p -Cd_xHg_{1-x}Te, обусловленные перезарядкой поверхностных состояний. С.Г. Гасанзаде, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский 4 431
- Разработка фотоприемников для преобразователей изображений: легирование кремния селеном из газовой фазы. Ю.А. Астров, В.Б. Шуман, А.Н. Лодыгин, Л.М. Порцель, А.Н. Махова 4 457
- Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллических соединений AgCd₂GaS₄. Л.В. Булатецкая, В.В. Божко, Г.Е. Давидюк, О.В. Парасюк 5 522
- Резонансное спиновое усиление в наноструктурах с анизотропной спиновой релаксацией и разбросом электронного g -фактора. М.М. Глазов, Е.Л. Ивченко 8 966
- Thermal orientation of electron spins. S.A. Tarasenko 8 982
- Эффекты самосогласованного электростатического потенциала в квантовых ямах с несколькими уровнями размерного квантования в сильных магнитных полях. А.А. Грешнов, Г.Г. Зегря 8 994
- Влияние магнитного поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода n -GaAs- p -Ge. М.М. Гаджиалиев, З.Ш. Пирмагомедов 9 1050
- Вызванные действием магнитного поля изменения примесного состава и микротвердости приповерхностных слоев кристаллов кремния. В.А. Макара, М.А. Васильев, Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, С.Н. Науменко 9 1061
- Магнитофотолюминесценция в разъединенном гетеропереходе II типа n -GaInAsSb/ p -InAs. К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев, К. Королев, С. McInning, V. McCombe 9 1126

- Мессбауэровские U^- -центры как инструмент исследования бозе-конденсации в полупроводниках. Г.А. Бордовский, С.А. Немов, А.В. Марченко, П.П. Серегин, А.В. Зайцева 10 1172
- Электронный парамагнитный резонанс взаимодействующих спинов в n -Ge II. Изменение ширины и формы линий. А.И. Вейгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек, С.И. Голощанов 11 1301
- Свойства и структура стекол $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe_2)_z-x(Tl_2Se)_x$ и $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe)_z-x(Tl_2Se)_x$. Г.А. Бордовский, А.В. Марченко, Е.И. Теруков, П.П. Серегин, Т.В. Лиходеева 11 1353
- 5.5. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)**
- Влияние примеси йода на релаксацию фотовозбужденного хлорида серебра. Ю.В. Вострикова, В.Г. Клосев 3 277
- Оптическая ориентация дырок в деформированных наноструктурах. Н.С. Аверкиев, Н.И. Саблина . . . 3 316
- Поляризационная пьезоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы $GaAs/Al_{0.35}Ga_{0.65}As:Ve$. Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов 3 322
- О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах n - $InGaAs/GaAs$ с квантовыми ямами. П.А. Белевский, М.Н. Винославский, В.Н. Порошин, И.В. Строганова 5 604
- Фундаментальные спектры оптических функций ферроэлектрика нитрида натрия. В.В. Соболев, А.И. Калугин, В.Вал. Соболев, С.Г. Исхакова 7 777
- Учет спонтанной поляризации в задаче о гетероструктуре $NH-SiC/3C-SiC/NH-SiC$, образованной кубическим (3C) и гексагональными (NH) поли типами карбида кремния. С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин 10 1206
- Роль спонтанной поляризации в формировании структур $NH-SiC/3C-SiC/NH-SiC$ на основе политипов карбида кремния. С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин . . . 11 1318
- 5.6. Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)**
- Эмиссия горячих электронов, возбужденных в ходе каталитической реакции, из металла в полупроводник. В.Ф. Харламов, А.В. Костин, М.В. Кубышкина, Ф.В. Харламов 1 60
- Каналы излучательной рекомбинации в $Si/Si_{1-x}Ge_x$ -наноструктурах. Ю.А. Берашевич, А.С. Панфиленок, В.Е. Борисенко 1 68
- Сдвиг-структура $InGaAs/GaAs$ с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин 1 101
- Вклад оже-рекомбинации в насыщение ватт-амперных характеристик мощных полупроводниковых лазеров ($\lambda = 1.0-1.9$ мкм). А.В. Лютецкий, К.С. Борщев, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов 1 106
- Пространственное распределение дефектов и кинетика неравновесных носителей заряда в вюрцитных кристаллах GaN, легированных Sm, Eu, Er, Tm и дополнительно введенной примесью Zn. М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова 2 157
- Стимулированное излучение гетероструктур на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$ при комнатной температуре в условиях оптической накачки. А.А. Андронов, Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков, А.А. Бабенко, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Р.Н. Смирнов 2 177
- Действие мощных нано- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann 2 181
- Фотолюминесценция локализованных экситонов в квантовых точках $InGaN$. С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, Н.Н. Леденцов 2 187
- Оптические исследования пленок $AlN/n-Si(100)$, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления. Н.С. Заяц, В.Г. Бойко, П.А. Генцарь, О.С. Литвин, В.П. Папуша, Н.В. Сопинский 2 195
- Сравнительный анализ фото- и электролюминесценции многослойных структур с самоформирующимися островками $Ge(Si)/Si(001)$. Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, К.Е. Кудрявцев, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, М.В. Шалеев, Д.В. Шенгуров, В.Б. Шмагин, А.Н. Яблонский 3 291
- Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя $InAs$. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин 3 303
- Поляризационная пьезоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы $GaAs/Al_{0.35}Ga_{0.65}As:Ve$. Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов 3 322
- Спектры излучения гетероструктур с квантовыми ямами типа $InGaN/AlGaIn/GaN$: модель двумерной комбинированной плотности состояний. М.Л. Бадгудинов, А.Э. Юнович 4 438
- Нелинейно-оптическое преобразование частоты в двухцветном лазере с вертикальным внешним резонатором. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, Т. Leinonen, М.Ю. Морозов 4 473
- Инфракрасные спектры пропускания фотолюминесцентных пленок оксидов с Si-, Ge-квантовыми точками, сформированных импульсным лазерным осаждением. И.П. Лисовский, С.А. Злобин, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун 5 560
- Усиление фотолюминесценции структур с нанокристаллическим кремнием, стимулированное низкодозовым γ -облучением. И.П. Лисовский, И.З. Индутный, М.В. Муравская, В.В. Войтович, Е.Г. Гуле, П.Е. Шепелявый 5 591
- Особенности долговременной релаксации емкости в выпрямляющих структурах на основе моноклинного ZnP_2 n -типа проводимости. И.Г. Стамов, Д.В. Ткаченко 6 679
- Рентгеноспектральный микроанализ полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур на основе моделирования транспорта электронов методом Монте-Карло. Т.Б. Попова, Л.А. Бакалейников, М.В. Заморянская, Е.Ю. Флегонтова 6 686

- Изменение оптических свойств нанокластеров CdS, полученных методом Ленгмюра—Блоджетт, при пассивации в аммиаке.** Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, Д.В. Щеглов 6 718
- Энергетические характеристики экситонов в структурах на основе твердых растворов InGaN.** С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, М.А. Синицын, Н.Н. Леденцов 6 736
- Формирование SiO_x-слоев при плазменном распылении Si- и SiO₂-мишеней.** А.Н. Карпов, Д.В. Марин, В.А. Володин, J. Jędrzejewski, Г.А. Качурин, E. Savič, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая, Y. Goldstein, I. Balberg 6 747
- Спектры фотолуминесценции гетероструктур *n-ZnO/p-GaN(Er + Zn)* и *p-AlGaN(Er + Zn)*.** М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Н.А. Феоктистов, Э.Ю. Даниловский, Р.В. Кузьмин, С.В. Разумов, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов 7 782
- Нановключения InGaN в матрице AlGaN.** В.С. Сизов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин 7 804
- Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs.** В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов 7 823
- Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности *n-6H-SiC* под воздействием сверхвысокочастотной обработки.** Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин, О.Б. Охрименко, А.М. Светличный, В.В. Поляков 7 888
- Edge effects in propagation of terahertz radiation in subwavelength periodic structures.** B. Gelmont, R. Parthasarathy, T. Globus 8 940
- Резонансное спиновое усиление в наноструктурах с анизотропной спиновой релаксацией и разбросом электронного *g*-фактора.** М.М. Глазов, Е.Л. Ивченко 8 966
- Особенности оптической ориентации и релаксации электронных спинов в квантовых ямах с большим спиновым расщеплением.** Н.С. Аверкиев, М.М. Глазов 8 973
- Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs.** Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривоносос, Т.А. Налет 9 1053
- Барические свойства квантовых точек InAs.** Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелешак, О.О. Данькин, В.А. Гайсин, В.Г. Талалаев, И.В. Штром, Г.Э. Цырлин 9 1094
- Электрофизические и структурные свойства двусторонне δ-легированных PHEMT-гетероструктур на основе AlGaAs/InGaAs/AlGaAs.** И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, Е.А. Климов, В.Г. Мокеров, С.С. Широков, Р.М. Имамов, И.А. Субботин 9 1102
- Краевая люминесценция наностержней ZnO при оптическом возбуждении большой мощности.** А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, Е.Е. Якимов, К. Бартоу (С. Barthou) 9 1110
- Фотолуминесценция нанокластеров GeSi/Si, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа.** Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов 9 1116
- Магнитофотолуминесценция в разбеденном гетеропереходе II типа *n-GaInAsSb/p-InAs*.** К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев, К. Королев, С. Meinning, В. McCombe 9 1126
- Экситонные состояния и фотолуминесценция кремниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al₂O₃.** И.М. Купчак, Ю.В. Крюченко, Д.В. Корбутяк, А.В. Саченко, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун 10 1213
- Фотофизические свойства кремнийсодержащих полисилицилиденазометиннов.** Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин 10 1233
- Влияние уровня возбуждения на оптические свойства микродиска GaAs—AlGaO с активной областью на основе квантовых точек InAs.** А.М. Надточий, С.А. Блохин, А.В. Сахаров, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, Е. Шток, Т. Варминг, Д. Бимберг 10 1247
- Магнитооптика одиночной квантовой ямы CdMnSe/CdMgSe.** И.И. Решина, С.В. Иванов 11 1348
- Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока.** Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер 11 1384
- Субтерагерцовые автоколебания в сверхбыстрой автомодуляции поглощения света в GaAs.** Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривоносос 12 1426
- Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaN для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмонослойной дискретной молекулярно-лучевой эпитаксии с плазменной активацией азота.** В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, А.В. Сахаров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, С.В. Иванов, Е.В. Луценко, А.В. Данильчик, Н.В. Ржеуцкий, Г.П. Яблонский 12 1452

5.6.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)

- Оптическая спектроскопия свободных экситонов в халькопиритном полупроводниковом соединении CuInS₂.** А.В. Мудрый, А.В. Иванюкович, М.В. Якушев, Р. Мартин, А. Саад 1 31
- Вариация края поглощения света в пленках SiN_x с кластерами кремния.** М.Д. Ефремов, В.А. Володин, Д.В. Марин, С.А. Аржанникова, Г.Н. Камаев, С.А. Кочубей, А.А. Попов 2 202
- Оптические параметры диодных лазеров на основе InAsSb/InAsSbP-гетероструктуры.** А.П. Астахова, Т.В. Безязычная, Л.И. Буров, А.С. Горбачевич, А.Г. Рябцев, Г.И. Рябцев, М.А. Щемелев, Ю.П. Яковлев 2 228
- Исследование начальных стадий роста Mg на Si(111) при комнатной температуре методами оптической и электронной спектроскопии.** К.Н. Галкин, С.А. Доценко, Н.Г. Галкин, М. Kumar, Govind, S.M. Shivaprasad 4 485
- Фундаментальные спектры оптических функций ферроэлектрика нитрита натрия.** В.В. Соболев, А.И. Калугин, В.Вал. Соболев, С.Г. Исакова 7 777

- О пространственной симметрии возбужденных состояний в полупроводниках $A^{III}B^V$ в Г-точке.** В.Д. Дымников, О.В. Константинов 8 934
- Исследование монокристаллов тройного соединения $CuIn_3Se_5$.** И.В. Боднар 9 1046
- Магнитооптика одиночной квантовой ямы $CdMnSe/CdMgSe$.** И.И. Решина, С.В. Иванов 11 1348
- 5.6.2. Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)**
- Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Cu монокристаллов CdS .** Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин 4 399
- Релаксация возбужденных состояний доноров в кремнии с излучением междолинных фононов.** В.В. Цыпленков, Е.В. Демидов, К.А. Ковалевский, В.Н. Шасти 9 1032
- Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в $GaAs$.** Н.Н. Агеева, И.Л. Бронева, А.Н. Кривонос, Т.А. Налет 9 1053
- Инфракрасные спектры отражения многослойных эпитаксиальных гетероструктур с погруженными слоями $InAs$ и $GaAs$.** П.В. Середин, Э.П. Домашевская, А.Н. Лукин, И.Н. Арсентьев, Д.А. Винокуров, И.С. Тарасов 9 1072
- Колебательная спектроскопия аморфного углерода, модифицированного Pt .** В.И. Иванов-Омский, Т.К. Звонарева, Г.С. Фролова 9 1131
- Фотофизические свойства кремнийсодержащих полисилицилиденазометининов.** Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин 10 1233
- Субтерагерцовые автоколебания в сверхбыстрой автомодуляции поглощения света в $GaAs$.** Н.Н. Агеева, И.Л. Бронева, А.Н. Кривонос 12 1426
- 5.6.3. Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)**
- Оптическая спектроскопия свободных экситонов в халькопиритном полупроводниковом соединении $CuInS_2$.** А.В. Мудрый, А.В. Иванюкович, М.В. Якушев, Р. Мартин, А. Саад 1 31
- Эмиссия горячих электронов, возбужденных в ходе каталитической реакции, из металла в полупроводник.** В.Ф. Харламов, А.В. Костин, М.В. Кубышкина, Ф.В. Харламов 1 60
- Каналы излучательной рекомбинации в $Si/Si_{1-x}Ge_x$ наноструктурах.** Ю.А. Берашевич, А.С. Панфиленок, В.Е. Борисенко 1 68
- Сэндвич-структура $InGaAs/GaAs$ с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников.** Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин 1 101
- Электрофизические свойства слоев $Si:Er/Si$, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии.** О.В. Белова, В.Н. Шабанов, А.П. Касаткин, О.А. Кузнецов, А.Н. Яблонский, М.В. Кузнецов, В.П. Кузнецов, А.В. Корнаухов, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник 2 136
- Пространственное распределение дефектов и кинетика неравновесных носителей заряда в вюрцитных кристаллах GaN , легированных Sm , Eu , Er , Tm и дополнительно введенной примесью Zn .** М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова 2 157
- Стимулированное излучение гетероструктур на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$ при комнатной температуре в условиях оптической накачки.** А.А. Андронов, Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков, А.А. Бабенко, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Р.Н. Смирнов 2 177
- Фотолюминесценция локализованных экситонов в квантовых точках $InGaN$.** С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, Н.Н. Леденцов 2 187
- Влияние водорода на анизотропию скорости роста $p-GaN$ при газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на стенках мезаполосков.** В.В. Лундин, А.Е. Николаев, А.В. Сахаров, А.Ф. Цацульников 2 233
- О способах испарения Si и легирующих примесей в методах вакуумной эпитаксии.** В.П. Кузнецов, Н.А. Алябина, В.А. Боженкин, О.В. Белова, М.В. Кузнецов 3 257
- Влияние примеси йода на релаксацию фотовозбужденного хлорида серебра.** Ю.В. Вострикова, В.Г. Клюев 3 277
- Влияние ультразвуковой обработки на фотоэлектрические и люминесцентные свойства кристаллов $ZnSe$.** Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, Ф.С. Габитов, И.К. Камилов, Ф.И. Маняхин, Е.К. Наими 3 282
- Сравнительный анализ фото- и электролюминесценции многослойных структур с самоформирующимися островками $Ge(Si)/Si(001)$.** Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, К.Е. Кудрявцев, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, М.В. Шалеев, Д.В. Шенгуров, В.Б. Шагин, А.Н. Яблонский 3 291
- Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя $InAs$.** М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин 3 303
- Поляризационная пьезоспектроскопия фотолюминесценции квантовой ямы $GaAs/Al_{0.35}Ga_{0.65}As:Be$.** Н.С. Аверкиев, Ю.Л. Иванов, А.А. Красивичев, П.В. Петров, Н.И. Саблина, В.Е. Седов 3 322
- Фотолюминесценция полупроводниковых структур на основе бутилзамещенных фталоцианинов эрбия.** И.А. Белогорохов, Ю.В. Рябчиков, Е.В. Тихонов, В.Е. Пушкарев, М.О. Бреусова, Л.Г. Томилова, Д.Р. Хохлов 3 327
- Кремниевые светодиоды с большой мощностью излучения краевой люминесценции.** А.М. Емельянов, Н.А. Соболев 3 336
- Люминесцентные свойства светодиодов на основе арсенида галлия с антистоксовым люминофором $Y_2O_3S:Er,Yb$.** А.Н. Грузинцев, К. Бартхоу, П. Беналул 3 365
- Особенности оптических и фотоэлектрических свойств специально не легированных и легированных Cu монокристаллов CdS .** Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Г.Л. Мирончук, Л.В. Булатецкая, А.Г. Кевшин 4 399

- Спектры излучения гетероструктур с квантовыми ямами типа InGaN/AlGaIn/GaN: модель двумерной комбинированной плотности состояний. М.Л. Бадгутдинов, А.Э. Юнович 4 438
- Исследование начальных стадий роста Mg на Si(111) при комнатной температуре методами оптической и электронной спектроскопии. К.Н. Галкин, С.А. Доценко, Н.Г. Галкин, М. Kumar, Govind, S.M. Shivaprasad 4 485
- Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллических соединений $\text{AgCd}_2\text{GaS}_4$. Л.В. Булатецкая, В.В. Божко, Г.Е. Давидюк, О.В. Парасюк 5 522
- Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов $\text{GaS}_x\text{Se}_{1-x}$. А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.Г. Мохтари, В.В. Дадашова, А.А. Агаева 5 532
- У- и Z-люминесценция поликристаллического теллурида кадмия, полученного неравновесной реакцией прямого синтеза компонентов. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 5 536
- Особенности спектров собственной фотопроводимости в фосфиде индия, компенсированном медью. Ф.В. Макаренко, Н.Н. Прибылов, С.И. Рембеза, В.А. Мельник 5 542
- Резонансное туннелирование носителей в фотовозбужденных гетероструктурах 2-го типа ZnSe/BeTe. С.В. Зайцев, А.А. Максимов, И.И. Тартаковский, Д.Р. Яковлев, А. Вагг 5 555
- Инфракрасные спектры пропускания фотолуминесцентных пленок оксидов с Si-, Ge-квантовыми точками, сформированных импульсным лазерным осаждением. И.П. Лисовский, С.А. Злобин, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун 5 560
- Теоретическое исследование процессов ожереккомбинации в глубоких квантовых ямах. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря 5 566
- Пороговые характеристики ИК-лазера на основе глубоких квантовых ям InAsSb/AlSb. Л.В. Данилов, Г.Г. Зегря 5 573
- Усиление фотолуминесценции структур с нанокристаллическим кремнием, стимулированное низкодозовым γ -облучением. И.П. Лисовский, И.З. Индутный, М.В. Муравская, В.В. Войтович, Е.Г. Гуле, П.Е. Шепелявый 5 591
- Собственная люминесценция Tb в металл-полимерных комплексах полиамидокислот. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, С.Е. Никитин, П.А. Форш, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский 5 618
- Источники спонтанного излучения на основе арсенида индия. Н.В. Зотова, Н.Д. Ильинская, С.А. Карандашёв, Б.А. Матвеев, М.А. Реманный, Н.М. Стусь 6 641
- Релаксация параметров тонкопленочных электролюминесцентных структур на основе ZnS:Mn при выключении. Н.Т. Гурин, О.Ю. Сабитов 6 692
- Изменение оптических свойств нанокластеров CdS, полученных методом Ленгмюра—Блоджетт, при пассивации в аммиаке. Е.А. Багасев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, Д.В. Щеглов 6 718
- Формирование сверхизлучения в наногетероструктурах с квантовыми точками. А.В. Савельев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Р.П. Сейсян, Г.Г. Зегря 6 730
- Энергетические характеристики экситонов в структурах на основе твердых растворов InGaN. С.О. Усов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин, А.В. Сахаров, Е.Е. Заварин, М.А. Синецын, Н.Н. Леденцов 6 736
- Формирование SiO_x -слоев при плазменном распылении Si- и SiO_2 -мишеней. А.Н. Карпов, Д.В. Марин, В.А. Володин, J. Jedrzejewski, Г.А. Качурин, E. Savir, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая, Y. Goldstein, I. Balberg 6 747
- Концентрация и температура носителей заряда в квантовых ямах лазерных гетероструктур в режимах спонтанного и стимулированного излучения. Л.Е. Воробьев, В.Л. Зерова, К.С. Борщёв, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов, G. Belenky 6 753
- Спектры фотолуминесценции гетероструктур $n\text{-ZnO}/p\text{-GaN}(\text{Er} + \text{Zn})$ и $p\text{-AlGaIn}(\text{Er} + \text{Zn})$. М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Н.А. Феоктистов, Э.Ю. Даниловский, Р.В. Кузьмин, С.В. Разумов, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов 7 782
- Нановключения InGaIn в матрице AlGaIn. В.С. Сизов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин 7 804
- Периодическое создание кратковременной инверсии населенностей на межподзонных лазерных переходах в квантовых ямах. В.А. Кукушкин 7 810
- Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs. В.В. Мамутин, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов 7 823
- Управление заселенностью верхней рабочей подзоны электрическим полем в структурах с асимметричными барьерами для униполярного лазера. Ю.А. Алещенко, А.Е. Жуков, В.В. Капаев, Ю.В. Копаев, П.С. Копьев, В.М. Устинов 7 856
- Состав и параметры доменов, образующихся в результате спиноподобного распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах $\text{GaInP/Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}_y\text{P}_{1-y}/\text{GaInP/GaAs}(001)$. Э.П. Домашевская, Н.Н. Гордиенко, Н.А. Румянцева, П.В. Середин, Б.Л. Агапов, Л.А. Битюцкая, И.Н. Арсентьев, Л.С. Вавилова, И.С. Тарасов 9 1086
- Барические свойства квантовых точек InAs. Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелешак, О.О. Данькин, В.А. Гайсин, В.Г. Талалаев, И.В. Штром, Г.Э. Цырлин 9 1094
- Краевая люминесценция наностержней ZnO при оптическом возбуждении большой мощности. А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, Е.Е. Якимов, К. Бартоу (C. Barthou) 9 1110
- Магнитофотолуминесценция в разьединенном гетеропереходе II типа $n\text{-GaInAsSb}/p\text{-InAs}$. К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев, К. Королев, С. Meining, V. McCombe 9 1126
- Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, В.А. Володин 9 1145
- Исследование свойств эпитаксиального и слиткового антимонида галлия. В.П. Хвостиков, С.В. Сорокина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев 10 1198
- Экситонные состояния и фотолуминесценция кремниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al_2O_3 . И.М. Купчак, Ю.В. Крюченко, Д.В. Корбутяк, А.В. Саченко, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун 10 1213

- Фотофизические свойства кремнийсодержащих полидисульфидазометинов.** Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин 10 1233
- Особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально не легированных и легированных Си монокристаллов CdS.** Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая 10 1263
- Влияние электрического поля при получении пленок α -SiO₂:H(Er,O) методом магнетронного распыления на постоянном токе на их состав и интенсивность фотолюминесценции ионов эрбия.** Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.М. Лебедев 11 1357
- Светочувствительные свойства металлосодержащих полидисульфидазометинов.** Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин 11 1367
- Измерение коэффициента поглощения света, распространяющегося латерально в светодиодных структурах с квантовыми ямами In_{0,2}Ga_{0,8}N/GaN.** Ю.С. Леликов, Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, Д.В. Тархин, Ю.Г. Шретер 11 1371
- Краевая электролюминесценция эффективного точечного кремниевого светодиода в области температур 80–300 К.** А.М. Емельянов 11 1375
- Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока.** Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер 11 1384
- 5.6.4. Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т. п.) (PACS 78.66)**
- Роль фоновых примесей О и Си в оптике кристаллов ZnSe с позиций теории непересекающихся зон.** Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, Е.М. Гавришук, В.Г. Галстян 2 131
- Стимулированное излучение гетероструктур на основе Cd_xHg_{1-x}Te при комнатной температуре в условиях оптической накачки.** А.А. Андронов, Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков, А.А. Бабенко, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Р.Н. Смирнов 2 177
- Эффективная генерация первой волноводной моды в гетеролазере InGaAs/GaAs/InGaP.** А.А. Бирюков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, В.Я. Алёшкин, А.А. Дубинов, В.В. Кочаровский, Вл.В. Кочаровский 3 361
- Влияние условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия (IFO) на фотоэлектрические свойства гетероперехода IFO/p-Si.** Г.Г. Унтила, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха 4 415
- Свойства пленок оксида цинка, синтезированных в низкотемпературном плазменном разряде в условиях бомбардировки компонентами плазмы.** А.А. Сердобинцев, А.Г. Веселов, О.А. Кирясова . . 4 496
- Особенности спектров собственной фотопроводимости в фосфиде индия, компенсированном медью.** Ф.В. Макаренко, Н.Н. Прибылов, С.И. Рембеза, В.А. Мельник 5 542
- Собственная люминесценция Tb в металл-полимерных комплексах полиамидокислот.** Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, С.Е. Никитин, П.А. Форш, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский 5 618
- О волновых функциях горячих экситонов в полупроводниках с вырожденными зонами.** А.В. Ефанов . . 6 658
- Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. I. Теория, оптические свойства материалов.** Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов 7 864
- Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. II. Анализ гетероструктур на различных подложках.** Т.Е. Слободян, К.А. Булашевич, С.Ю. Карпов 7 871
- Резонансное спиновое усиление в наноструктурах с анизотропной спиновой релаксацией и разбросом электронного g-фактора.** М.М. Глазов, Е.Л. Ивченко 8 966
- Особенности спектров люминесценции кристаллов ZnS(O) и ZnS·Cu(O) с позиций теории непересекающихся зон.** Н.К. Морозова, Д.А. Мидерос, В.Г. Галстян, Е.М. Гавришук 9 1039
- Инфракрасные спектры отражения многослойных эпитаксиальных гетероструктур с погруженными слоями InAs и GaAs.** П.В. Середин, Э.П. Домашевская, А.Н. Лукин, И.Н. Арсентьев, Д.А. Винокуров, И.С. Тарасов 9 1072
- Фотолюминесценция нанокластеров GeSi/Si, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа.** Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов 9 1116
- Фотофизические свойства кремнийсодержащих полидисульфидазометинов.** Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин 10 1233
- Свойства и структура стекол (As₂Se₃)_{1-z}(SnSe)_{z-x}(Te₂Se)_x и (As₂Se₃)_{1-z}(SnSe)_{z-x}(Te₂Se)_x.** Г.А. Бордовский, А.В. Марченко, Е.И. Теруков, П.П. Серегин, Т.В. Лиходеева 11 1353
- Светочувствительные свойства металлосодержащих полидисульфидазометинов.** Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов, Н.М. Геллер, Л.Б. Надеждина, В.В. Шаманин 11 1367
- Измерение коэффициента поглощения света, распространяющегося латерально в светодиодных структурах с квантовыми ямами In_{0,2}Ga_{0,8}N/GaN.** Ю.С. Леликов, Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, Д.В. Тархин, Ю.Г. Шретер 11 1371
- 5.7. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)**
- Действие мощных нано- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры.** Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann 2 181

- Малолумящие фотодиоды на основе двойной гетероструктуры GaSb/GaInAsSb/AlGaAsSb для спектрального диапазона 1–4.8 мкм. Б.Е. Журтанов, Н.Д. Ильинская, А.Н. Именков, М.П. Михайлова, К.В. Калинина, М.А. Сиповская, Н.Д. Стоянов, Ю.П. Яковлев 4 468
- Высокочастотные свойства двухъямных наноструктур. В.Ф. Елесин, И.Ю. Катеев 5 586
- Рентгеноспектральный микроанализ полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур на основе моделирования транспорта электронов методом Монте-Карло. Т.Б. Попова, Л.А. Бакалейников, М.В. Заморянская, Е.Ю. Флегонтова 6 686
- 6. Физика полупроводниковых приборов (PACS 84; 85)**
- Линейная стадия эволюции электронно-дырочных лавин в полупроводниках. А.С. Кюрегян 1 23
- Расщепление пика натрия на динамических вольт-амперных характеристиках конвективных ионных токов структур металл–окисел–полупроводник. С.Г. Дмитриев, Ю.В. Маркин 1 45
- Высокотемпературные матрицы детекторов ядерного излучения на основе 4H-SiC ионно-легированных $p^+ - n$ -переходов. Е.В. Калинина, Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Ситникова, А.В. Садохин, А.Ю. Азаров, В.Г. Коссов, Р.Р. Яфаев 1 87
- Восстановление профиля потенциала в изолирующем слое по вольт-амперным характеристикам туннельных МДП диодов. Е.И. Гольдман, А.Г. Ждан, Н.Ф. Кухарская, М.В. Черняев 1 94
- Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин 1 101
- Вклад оже-рекомбинации в насыщение ватт-амперных характеристик мощных полупроводниковых лазеров ($\lambda = 1.0 - 1.9$ мкм). А.В. Лютецкий, К.С. Борщев, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов 1 106
- Инжекционные фотоприемники. И.М. Викулин, Ш.Д. Курмашев, В.И. Стафеев 1 113
- Электрофизические свойства слоев Si:Er/Si, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии. О.В. Белова, В.Н. Шабанов, А.П. Касаткин, О.А. Кузнецов, А.Н. Яблонский, М.В. Кузнецов, В.П. Кузнецов, А.В. Корнаухов, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник 2 136
- Влияние оже-рекомбинации на тепловую стабильность мощных высоковольтных полупроводниковых диодов. Т.Т. Мнацаканов, М.Е. Левинштейн, А.С. Фрейдлин 2 220
- Влияние водорода на анизотропию скорости роста p -GaN при газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на стенках мезаполосков. В.В. Лундин, А.Е. Николаев, А.В. Сахаров, А.Ф. Цацульников 2 233
- О способах испарения Si и легирующих примесей в методах вакуумной эпитаксии. В.П. Кузнецов, Н.А. Алябина, В.А. Боженкин, О.В. Белова, М.В. Кузнецов 3 257
- Моделирование приповерхностной протонно-стимулированной диффузии бора в кремнии. О.В. Александров, В.В. Козловский 3 262
- Механизмы выпрямления высокочастотного сигнала полевым гетеротранзистором с коротким каналом. М.Л. Орлов 3 346
- Electrical properties of InP/InGaAs ppn heterostructure-emitter bipolar transistor. Jung-Hui Tsai, Wen-Chau Liu, Der-Feng Guo, Yu-Chi Kang, Shao-Yen Chiu, Wen-Shiung Lour 3 353
- Люминесцентные свойства светодиодов на основе арсенида галлия с антистоксовым люминофором $Y_2O_3S:Er,Yb$. А.Н. Грузинцев, К. Бартоу, П. Беналул 3 365
- Влияние условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия (IFO) на фотоэлектрические свойства гетероперехода IFO/ p -Si. Г.Г. Унтила, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха 4 415
- Спектры излучения гетероструктур с квантовыми ямами типа InGaN/AlGaIn/GaN: модель двумерной комбинированной плотности состояний. М.Л. Бадгудинов, А.Э. Юнович 4 438
- Динамика формирования фотоответа в детекторной структуре из арсенида галлия. Г.И. Айзенштат, М.А. Лелеков, О.П. Толбанов 4 451
- Разработка фотоприемников для преобразователей изображений: легирование кремния селеном из газовой фазы. Ю.А. Астров, В.Б. Шуман, А.Н. Лодыгин, Л.М. Порцель, А.Н. Махова 4 457
- Термостойкий диод Шоттки $TiV_x - n$ -GaP. А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Б. Камалов, Л.М. Капитанчук, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, М.У. Насыров 4 463
- Малолумящие фотодиоды на основе двойной гетероструктуры GaSb/GaInAsSb/AlGaAsSb для спектрального диапазона 1–4.8 мкм. Б.Е. Журтанов, Н.Д. Ильинская, А.Н. Именков, М.П. Михайлова, К.В. Калинина, М.А. Сиповская, Н.Д. Стоянов, Ю.П. Яковлев 4 468
- Нелинейно-оптическое преобразование частоты в двухцветном лазере с вертикальным внешним резонатором. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, Т. Leinonen, М.Ю. Морозов 4 473
- Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов GaS_xSe_{1-x} . А.Г. Кязым-заде, В.М. Салманов, А.Г. Мохтари, В.В. Дадашова, А.А. Агасва 5 532
- Источники спонтанного излучения на основе арсенида индия. Н.В. Зотова, Н.Д. Ильинская, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь 6 641
- Электронные характеристики однократно ионизированной пары доноров фосфора в кремнии и операции с зарядовыми кубитами. А.Н. Воронько 6 672
- О воздействии оптического излучения на чувствительность газовых сенсоров на основе пленок SnO_{2-x} . А.М. Гуляев, Ле Ван Ван, О.Б. Сарач, О.Б. Мухина 6 742
- Концентрация и температура носителей заряда в квантовых ямах лазерных гетероструктур в режимах спонтанного и стимулированного излучения. Л.Е. Воробьев, В.Л. Зерова, К.С. Борщев, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов, G. Belenky 6 753

- Свойства барьерных контактов к InP с наноразмерными слоями TiB_x. И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль, И.С. Тарасов, Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, А.Е. Беляев, А.Б. Камалов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, Е.В. Руссу 7 793
- Нановключения InGaN в матрице AlGaN. В.С. Сизов, А.Ф. Цацульников, В.В. Лундин 7 804
- Measurement and comparison of silicon *p-i-n* photodiodes ac impedance at different voltages. S. Özden, H. Bayhan, A. Dönmez, M. Bayhan 7 852
- Boundary instability of a two-dimensional electron fluid. M.I. Dyakonov 8 998
- Сравнительный анализ предельной эффективности фотопреобразования обычных солнечных элементов и солнечных элементов с квантовыми ямами. А.В. Саченко, И.О. Соколовский 10 1238
- Влияние уровня возбуждения на оптические свойства микродиска GaAs—AlGaO с активной областью на основе квантовых точек InAs. А.М. Надточий, С.А. Блохин, А.В. Сахаров, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, Е. Шток, Т. Варминг, Д. Бимберг 10 1247
- Каталитические свойства композитных слоев аморфный углерод—платина в топливных элементах. А.А. Нечитайлов, Т.К. Звонарева, А.Д. Ременюк, В.А. Толмачев, Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, Л.В. Беляков, О.М. Сресели 10 1268
- Образование омических контактов к низкоомному Cd_{1-x}Mg_xTe для фотовольтаических применений. О.А. Парфенюк, М.И. Илащук, К.С. Ульяницкий 11 1314
- Особенности световых вольт-амперных характеристик *p-i-n*-структур на аморфном кремнии при туннельно-дрейфовом механизме переноса темного тока. А.А. Андреев 11 1363
- Измерение коэффициента поглощения света, распространяющегося латерально в светодиодных структурах с квантовыми ямами In_{0,2}Ga_{0,8}N/GaN. Ю.С. Леликов, Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, Д.В. Тархин, Ю.Г. Шретер 11 1371
- Краевая электролюминесценция эффективного точечного кремниевого светодиода в области температур 80—300 К. А.М. Емельянов 11 1375
- Особенности вольт-фарадных характеристик МОП структур, обусловленные зарядом в окисле. Е.А. Боброва, Н.М. Омеляновская 11 1380
- Оптические свойства голубых светодиодов в системе InGaN/GaN при высокой плотности тока. Н.И. Бочкарева, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Т. Ребане, А.С. Белов, Ю.Г. Шретер 11 1384
- Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaIn для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмонослойной дискретной молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота. В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, А.В. Сахаров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, С.В. Иванов, Е.В. Луценко, А.В. Данильчик, Н.В. Ржеуцкий, Г.П. Яблонский 12 1452
- Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электроннолучевой накачкой на основе многослойных наноструктур A^{IV}B^{VI}. М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, Д.В. Перегудов, В.Б. Студенов, И.В. Седова, С.В. Гронин, С.В. Сорокин, С.В. Иванов, П.С. Копьев 12 1472
- Рост слитков карбида кремния политипа 4H на затравках с плоскостью (10 $\bar{1}0$). Д.Д. Авров, А.В. Булатов, С.И. Дорожкин, А.О. Лебедев, Ю.М. Таиров 12 1483
- ## 7. Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур (PACS 81; 85)
- Возможности и основные принципы управления пластической релаксацией пленок GeSi/Si и Ge/Si ступенчато изменяемого состава. Ю.Б. Болховитянов, А.К. Гутаковский, А.С. Дерябин, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов 1 3
- Эмиссия горячих электронов, возбужденных в ходе каталитической реакции, из металла в полупроводник. В.Ф. Харламов, А.В. Костин, М.В. Кубышкина, Ф.В. Харламов 1 60
- In situ исследование кинетики формирования КТ InSb в матрице InAs(Sb). А.Н. Семенов, О.Г. Люблинская, В.А. Соловьев, Б.Я. Мельцер, С.В. Иванов 1 75
- Сэндвич-структура InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников. Л.Д. Молдавская, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, В.И. Шашкин 1 101
- Оптические свойства твердых растворов AgGa_xIn_{1-x}Se₂. И.В. Боднар 2 153
- Действие мощных нано- и фемтосекундных лазерных импульсов на кремниевые наноструктуры. Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, В.А. Володин, Д.В. Марин, М. Deutschmann 2 181
- Вариация края поглощения света в пленках SiN_x с кластерами кремния. М.Д. Ефремов, В.А. Володин, Д.В. Марин, С.А. Аржанникова, Г.Н. Камаев, С.А. Кочубей, А.А. Попов 2 202
- Влияние водорода на анизотропию скорости роста *p*-GaIn при газофазной эпитаксии из металлургических соединений на стенках мезаполосков. В.В. Лундин, А.Е. Николаев, А.В. Сахаров, А.Ф. Цацульников 2 233
- Диффузия хрома в эпитаксиальный арсенид галлия. М.Д. Вилисова, Е.П. Другова, И.В. Пономарев, В.А. Чубирко 2 239
- Фотолюминесценция с длиной волны до 1.6 мкм в квантовых точках с увеличенной эффективной толщиной слоя InAs. М.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.И. Шашкин 3 303
- Механизм формирования отклика газового сенсора водорода на основе кремниевого МОП диода. В.И. Гаман, В.И. Балоба, В.Ю. Грицьк, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина 3 341

- Собственный окисел, возникающий на поверхности скола селенида галлия в результате длительного хранения. С.И. Драпак, С.В. Гаврилюк, З.Д. Ковалюк, О.С. Литвин 4 423
- Динамика формирования фотоответа в детекторной структуре из арсенида галлия. Г.И. Айзенштат, М.А. Лелеков, О.П. Толбанов 4 451
- Термостойкий диод Шоттки $TiV_x-n-GaP$. А.Е. Беляев, Н.С. Болговец, В.Н. Иванов, А.Б. Камалов, Л.М. Капитанчук, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, М.У. Насыров 4 463
- Краевой эффект при электрохимическом травлении кремния. Е.В. Астрова, А.А. Нечитайлов 4 480
- Свойства пленок оксида цинка, синтезированных в низкотемпературном плазменном разряде в условиях бомбардировки компонентами плазмы. А.А. Сердобинцев, А.Г. Веселов, О.А. Кирясова 4 496
- Сравнительный анализ механизмов формирования межфазной границы пленочной структуры в равновесных и резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов, Х.А. Тошходжаев 5 519
- Примесная проводимость монокристаллов $Hg_3In_2Te_6$. Л.А. Косяченко, И.И. Герман, И.М. Раренко, З.И. Захарук, Е.С. Никонюк 5 528
- Особенности спектров собственной фотопроводимости в фосфиде индия, компенсированном медью. Ф.В. Макаренко, Н.Н. Прибылов, С.И. Рембеза, В.А. Мельник 5 542
- Критическая толщина перехода по Странскому–Крастанову с учетом эффекта сегрегации. Д.В. Юрасов, Ю.Н. Дроздов 5 579
- Термическая неустойчивость фуллеренов кремния, стабилизируемых водородом. Компьютерный эксперимент. А.Е. Галашев 5 611
- Особенности пространственного распределения In в эпитаксиальных слоях $InGaN$, выращенных молекулярно-пучковой эпитаксией с плазменной активацией. В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, Д.С. Плотников, М.В. Заморянская, М.А. Яговкина, Я.В. Домрачева, А.А. Ситникова, С.В. Иванов 5 630
- Исследование зависимости электрофизических параметров пленок $Cd_xHg_{1-x}Te$, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, от уровня легирования индием. В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, Д.Г. Икусов, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров, Г.Ю. Сидоров, М.В. Якушев 6 664
- Исследование влияния температуры крекинга мышьяка на эффективность его встраивания в пленки $CdHgTe$ в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии. Г.Ю. Сидоров, Н.Н. Михайлов, В.С. Варавин, Д.Г. Икусов, Ю.Г. Сидоров, С.А. Дворецкий 6 668
- Изменение оптических свойств нанокластеров CdS , полученных методом Ленгмюра–Блоджетт, при пассивации в аммиаке. Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, Д.В. Щеглов 6 718
- Латеральное упорядочение нановискеров $GaAs$ на поверхностях $GaAs(111)B$ и $GaAs(110)$ при молекулярно-пучковой эпитаксии. Г.Э. Цырлин, Н.В. Сибирев, С. Sartel, J.-C. Harmand 6 726
- Формирование SiO_x -слоев при плазменном распылении Si- и SiO_2 -мишеней. А.Н. Карпов, Д.В. Марин, В.А. Володин, J. Jedrzejewski, Г.А. Качурин, E. Savir, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая, Y. Goldstein, I. Balberg 6 747
- Электрохимическое травление макропор в кремнии с щелевыми затравками. Е.В. Астрова, А.А. Нечитайлов 6 762
- Свойства барьерных контактов к InP с наноразмерными слоями TiV_x . И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль, И.С. Тарасов, Н.С. Болговец, В.Н. Иванов, А.Е. Беляев, А.Б. Камалов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, В.В. Миленин, Е.В. Руссу 7 793
- Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности $n-6H-SiC$ под воздействием сверхвысокочастотной обработки. Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин, О.Б. Охрименко, А.М. Светличный, В.В. Поляков 7 888
- Процессы возбуждения ионов Er^{3+} в SiO_2 с нанокристаллами Si. А.А. Прокофьев, А.С. Москаленко, И.Н. Ясиевич 8 985
- Релаксация возбужденных состояний доноров в кремнии с излучением междолинных фононов. В.В. Цыпленков, Е.В. Демидов, К.А. Ковалевский, В.Н. Шагин 9 1032
- Адсорбция метилтиола на поверхности $GaAs(100)-(2 \times 4)$: квантово-химический анализ из первых принципов. М.В. Лебедев 9 1065
- Состав и параметры доменов, образующихся в результате спиноподобного распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах $GaInP/Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}/GaInP/GaAs(001)$. Э.П. Домашевская, Н.Н. Гордиенко, Н.А. Румянцева, П.В. Середин, Б.Л. Агапов, Л.А. Битюцкая, И.Н. Арсентьев, Л.С. Вавилова, И.С. Тарасов 9 1086
- Барические свойства квантовых точек $InAs$. Б.В. Новиков, Г.Г. Зегря, Р.М. Пелешак, О.О. Данькин, В.А. Гайсин, В.Г. Талалаев, И.В. Штром, Г.Э. Цырлин 9 1094
- Фотолюминесценция нанокластеров $GeSi/Si$, формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа. Д.О. Филатов, М.В. Круглова, М.А. Исаков, С.В. Сипрова, М.О. Марычев, В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов 9 1116
- Диффузия имплантированного натрия в кислородном кремнии. В.М. Король, С.А. Веденяпин, А.В. Заставной, V. Ovchinnikov 9 1140
- Число Лоренца и фактор Холла в вырожденных полупроводниках при резонансном рассеянии носителей тока. Л.В. Прокофьева, А.А. Шабалдин, В.А. Корчагин, С.А. Немов, Ю.И. Равич 10 1180
- Исследование свойств эпитаксиального и слиткового антимолида галлия. В.П. Хвостиков, С.В. Сорокина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев 10 1198
- Экситонные состояния и фотолюминесценция кремниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al_2O_3 . И.М. Купчак, Ю.В. Крюченко, Д.В. Корбутяк, А.В. Саченко, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Е.В. Бегун 10 1213
- Особенности влияния электронной и нейтронной радиации на фотоэлектрические свойства специально не легированных и легированных Si монокристаллов CdS . Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая 10 1263
- Каталитические свойства композитных слоев аморфный углерод–платина в топливных элементах. А.А. Нечитайлов, Т.К. Звонарева, А.Д. Ременюк, В.А. Толмачев, Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина, Л.В. Беляков, О.М. Сресели 10 1268

- Образование омических контактов к низкоомному $\text{Cd}_{1-x}\text{Mg}_x\text{Te}$ для фотовольтаических применений.**
О.А. Парфенюк, М.И. Илащук, К.С. Ульяницкий . . . 11 1314
- Статические вольт-амперные характеристики туннельных МДП структур $\text{Au}/\text{CaF}_2/n\text{-Si}(111)$.** С.М. Сутурин, А.Г. Банщиков, Н.С. Соколов, С.Э. Тягинов, М.И. Векслер 11 1333
- Влияние электрического поля при получении пленок $\alpha\text{-SiO}_2 : \text{H}(\text{Er}, \text{O})$ методом магнетронного распыления на постоянном токе на их состав и интенсивность фотolumинесценции ионов эрбия.** Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.М. Лебедев 11 1357
- Особенности вольт-фарадных характеристик МОП структур, обусловленные зарядом в окисле.**
Е.А. Боброва, Н.М. Омеляновская 11 1380
- Модель термического окисления кремния на фронте объемной реакции.** О.В. Александров, А.И. Дусь . . 11 1400
- Исследование промежуточного слоя на гетерогранице $n^+\text{-CdS}/p\text{-CdTe}$.** С.А. Музафарова, Б.У. Айтбаев, Ш.А. Мирсагатов, К. Дуршимбетов, Ж. Жанабергенов 12 1409
- Квантово-размерные гетероструктуры на основе AlGaIn для светодиодов глубокого ультрафиолетового диапазона, полученные методом субмонослойной дискретной молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота.** В.Н. Жмерик, А.М. Мизеров, Т.В. Шубина, А.В. Сахаров, А.А. Ситникова, П.С. Копьев, С.В. Иванов, Е.В. Луценко, А.В. Данильчик, Н.В. Ржеуцкий, Г.П. Яблонский 12 1452
- Эффективный полупроводниковый лазер зеленого диапазона с электроннолучевой накачкой на основе многослойных наноструктур $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$.** М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Е.В. Жданова, Д.В. Перегудов, В.Б. Студенов, И.В. Седова, С.В. Гронин, С.В. Сорокин, С.В. Иванов, П.С. Копьев 12 1472
- Особенности формирования нитевидных нанокристаллов GaAs на различных поверхностях кремния при молекулярно-пучковой эпитаксии.** Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, В.П. Улин, В.Г. Дубровский 12 1478